



# Hi3516DV300 硬件设计 用户指南

文档版本 01  
发布日期 2019-09-12

Cogobuy Only For ShenZhen FuShi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.

**版权所有 © 上海海思技术有限公司 2019。保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



**HISILICON**、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 上海海思技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<http://www.hisilicon.com/cn/>

客户服务邮箱：[support@hisilicon.com](mailto:support@hisilicon.com)



# 前言

## 概述

本文档主要介绍 Hi3516DV300 芯片方案的硬件原理图设计、PCB 设计、单板热设计建议等。本文档提供 Hi3516DV300 芯片的硬件设计方法。

## 产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3516D	V300

## 读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 单板硬件开发工程师

## 修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2019-09-12	01	第一次正式版本发布 1.3.2.4 小节涉及修改 1.3.2.5 小节，表 1-10 和表 1-11 涉及修改
2019-01-15	00B04	第四次临时版本发布



修订日期	版本	修订说明
		1.1.1 小节，更新图 1-1 1.3.4 小节，表 1-12 涉及修改 新增 1.4.3 小节和 1.5 小节
2018-10-15	00B03	第三次临时版本发布 1.1.7 小节添加注意 1.3.2 小节，新增图 1-20 1.3.5 小节、2.4~2.7 小节、2.10~2.12 小节涉及修改
2018-09-06	00B02	第二次临时版本发布 1.1.2、1.2.2、1.3.5 和 2.10 涉及修改 1.2.6 小节，修改表 1-8 1.3.1 小节添加注意
2018-07-16	00B01	第一次临时版本发布

Cogobuy Only For ShenZhen FuShi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.



## 目 录

前 言.....	i
1 原理图设计.....	1
1.1 小系统外部电路要求.....	1
1.1.1 Clocking 电路.....	1
1.1.2 复位电路.....	2
1.1.3 JTAG 接口.....	2
1.1.4 电源管理（PMC）电路设计.....	4
1.1.5 HI3516DV300 硬件初始化系统配置电路.....	5
1.1.6 DDR 电路设计.....	6
1.1.7 FLASH 原理图设计.....	12
1.2 电源设计建议.....	15
1.2.1 CORE 电源设计.....	15
1.2.2 DDR 电源设计.....	15
1.2.3 IO 电源设计.....	16
1.2.4 PLL 电源设计.....	17
1.2.5 上下电时序.....	17
1.2.6 SVB 动态调压.....	18
1.3 外围接口设计建议.....	20
1.3.1 MAC 接口.....	20
1.3.2 音视频接口.....	22
1.3.3 SPI 和 I2C 接口.....	29
1.3.4 SDIO 设计.....	29
1.3.5 USB2.0 接口.....	30
1.3.6 ADC.....	30
1.3.7 RTC.....	30
1.3.8 PWM.....	30
1.3.9 UART.....	30
1.4 特殊管脚说明.....	31
1.4.1 未使用的模块处理.....	31
1.4.2 5V tolerance 管脚.....	36



1.4.3 防倒灌 GPIO 管脚说明 .....	36
1.5 在 DVDD33 上电过程中出现毛刺的 IO 说明 .....	37
<b>2 PCB 设计.....</b>	<b>41</b>
2.1 电源与滤波电容设计 .....	41
2.1.1 DVDD 电源 .....	41
2.1.2 DDR IO 电源设计 .....	41
2.1.3 PLL 电源设计 .....	42
2.1.4 模拟音频电源设计 .....	44
2.2 晶体电路设计 .....	45
2.3 DDR 电路设计 .....	45
2.4 FLASH 电路设计 .....	45
2.4.1 SPI FLASH .....	45
2.4.2 eMMC .....	45
2.5 RMII 信号 PCB 设计 .....	45
2.6 Video Input 信号 PCB 设计 .....	46
2.6.1 MIPI RX .....	46
2.6.2 Parallel CMOS .....	47
2.7 Video Output 信号 PCB 设计 .....	47
2.8 模拟音频电路设计 .....	48
2.9 SDIO 信号 PCB 设计 .....	48
2.10 USB2.0 信号设计 .....	49
2.11 MIPI TX 信号设计 .....	49
2.12 HDMI TX 信号设计 .....	49
<b>3 整机 ESD 设计 .....</b>	<b>51</b>
3.1 背景 .....	51
3.2 整机 ESD 设计 .....	51
<b>4 芯片散热设计.....</b>	<b>52</b>
4.1 最大功耗 .....	52



## 插图目录

图 1-1 晶体振荡电路 .....	1
图 1-2 RTC 推荐晶振连接方式及器件参数 .....	2
图 1-3 JTAG 连接方式 .....	3
图 1-5 DDR3(L)/DDR4 (T 型) 差分时钟信号一驱二应用 .....	10
图 1-6 DDR3(L)/DDR4 (flyby 型) 差分时钟信号一驱二应用 .....	11
图 1-7 DDR3(L)/DDR4 (T 型结构) 地址和命令信号一驱二应用 .....	11
图 1-8 DDR3(L)/DDR4 (flyby 型) 地址和命令信号一驱二应用 .....	12
图 1-9 SPI FLASH 连接示意图 .....	13
图 1-10 eMMC 连接示意图 .....	14
图 1-11 DDR4 电源分压网络参考设计 .....	15
图 1-12 DDR3(L)电源分压网络参考设计 .....	16
图 1-13 上电时序图 .....	17
图 1-14 下电时序图 .....	18
图 1-15 电源动态调压示意图 .....	19
图 1-16 Hi3516DV300 RMI 模式下的信号连接示意图 .....	21
图 1-17 MIC 单端输入电路 .....	23
图 1-18 MIC 差分输入电路 .....	23
图 1-19 “5 线模式” I2S 主模式连接方式 .....	24
图 1-20 “5 线模式” I2S 从模式连接方式 .....	25
图 1-21 对接双 sensor 配置接口接法 .....	25
图 1-22 对接单 sensor 配置接口接法 .....	26
图 2-1 AVDD09_PLL 供电滤波电路 SCH 设计 .....	42
图 2-2 AVDD09_PLL 供电滤波电路 PCB 设计 .....	42
图 2-3 AVDD33_PLL 供电滤波电路 SCH 设计 .....	43
图 2-4 AVDD33_PLL 供电滤波电路 PCB 设计 .....	43



图 2-5 AVDD33_DDR_PLL 供电滤波电路 SCH 设计 .....	44
图 2-6 AVDD33_DDR_PLL 供电滤波电路 PCB 设计 .....	44
图 2-7 MIPI/LVDS 差分信号隔离示意图.....	47
图 2-8 模拟音频信号包地示意图.....	48
图 2-9 模拟音频信号包地示意图.....	50

Cogobuy Only For ShenZhen FuShi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.





## 表格目录

表 1-1 JTAG 接口信号 .....	3
表 1-2 TEST_MODE 模式说明 .....	3
表 1-3 不同待机工作状态下 RTC 和 PMC 电源方案 .....	4
表 1-4 信号描述 .....	5
表 1-5 管脚 SWAP 信息 .....	7
表 1-6 SPI FLASH 匹配设计方法 .....	12
表 1-7 eMMC 匹配设计方法 .....	14
表 1-8 DVDD SVB 调压 RC 参数 .....	20
表 1-9 ETH MAC 信号设计方法 .....	21
表 1-10 信号接口模式与引脚对应关系 .....	27
表 1-11 并行 VO 信号设计要求 .....	28
表 1-12 SDIO 信号设计要求 .....	29
表 1-13 未使用模块电源及管脚处理建议 .....	31
表 1-14 5V tolerance 管脚 .....	36
表 1-15 不具有防倒灌功能管脚列表 .....	36
表 1-16 Hi3516DV300 在 DVDD33 上电过程中出现毛刺的 IO 统计表 .....	37



# 1 原理图设计

## 1.1 小系统外部电路要求

### 1.1.1 Clocking 电路

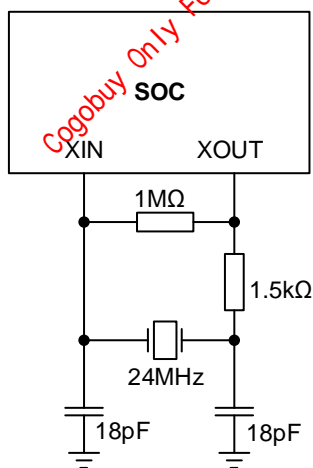
通过芯片内部的反馈电路与外部的 24MHz 晶体振荡电路一起构成系统时钟电路。

推荐晶振连接方式及器件参数如图 1-1 所示。

#### 注意

选用的电容需要跟晶振的负载电容匹配，材质建议采用 NPO。建议选用 4pin 贴片晶振，其中 2 个 GND 管脚与单板地充分连接，增强系统时钟抗 ESD 干扰能力。

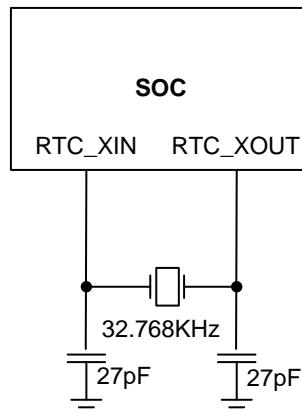
图1-1 晶体振荡电路



Hi3516DV300 内置 RTC，单板需要给 RTC 提供时钟电路，晶振连接方式及器件参数如图 1-2 所示。



图1-2 RTC 推荐晶振连接方式及器件参数



RTC 晶体选型约束：

- 晶体内阻不超过 75 k $\Omega$ ；

说明

- 电路中的电容取值需要与实际使用的晶体负载电容相匹配，满足 24MHz 频偏 30ppm；不同品牌、不同型号的晶体，其固有的负载电容参数可能不同，那么电路中的电容取值也会不同。
- 系统 24Mhz 时钟或者 RTC 时钟使用有源晶体时，从管脚 XIN 或者 RTC\_XIN 输入，管脚 XOUT 或者 RTC\_XOUT 悬空。

## 1.1.2 复位电路

Hi3516DV300 支持内部 POR（Power on Reset）复位，不支持外部复位。

主芯片上电后由内部 POR 电路对整个芯片进行复位（复位脉冲宽度约为 32ms）。

推荐客户采用 Hi3516DV300 芯片 T3 管脚 SYS\_RSTN\_OUT 输出复位信号来复位与小系统相关的外设（例如：存放 boot 的 flash 器件），SYS\_RSTN\_OUT 加 1K 下拉电阻。

SYS\_RSTN\_OUT 信号的电平与 DVDD3318\_FLASH（Hi3516DV300 的 R5 pin）保持一致。

### 注意

为确保系统能正常启动，小系统相关的外设（例如：存放 boot 的 FLASH 器件）必须先于或同时与 Hi3516DV300 一起释放复位信号，否则可能会出现无法启动等异常情况。

## 1.1.3 JTAG 接口

JTAG 接口信号描述如表 1-1 所示。



表1-1 JTAG 接口信号

信号名	信号描述
TCK	JTAG 时钟输入，要求单板外接 1K 下拉电阻。
TDI	JTAG 数据输入，要求单板外接 4.7K 上拉电阻。
TMS	JTAG 模式选择输入，要求单板外接 4.7K 上拉电阻。
TRSTN	JTAG 复位输入，正常工作要求单板外接 10K 下拉电阻。
TDO	JTAG 数据输出，要求单板外接 4.7K 上拉电阻。

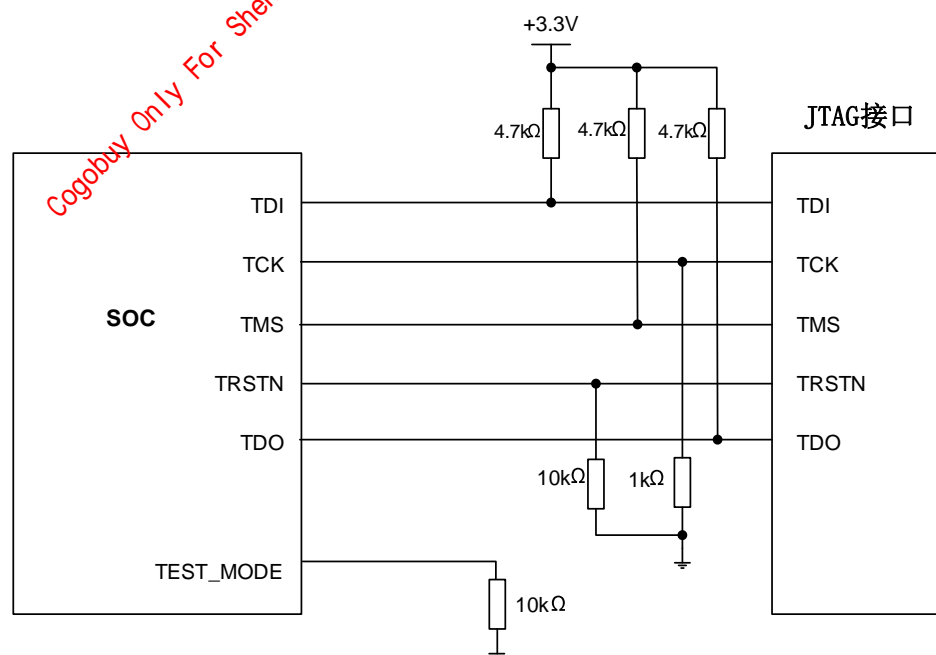
Hi3516DV300 可以通过 TEST\_MODE 管脚选择正常和测试两种工作模式，具体说明如表 1-2 所示。

表1-2 TEST\_MODE 模式说明

TEST_MODE	模式说明
0	正常工作模式
1	测试模式，实际产品中不用该功能

JTAG 连接方式及标准连接器管脚定义如图 1-3 所示。

图1-3 JTAG 连接方式





## 1.1.4 电源管理（PMC）电路设计

### 1.1.4.1 接口介绍

电源管理（PMC）模块可以对非常电区的供电模块进行使能控制，接收按键信号/上升沿信号进行上下电控制以及接收外设输出的唤醒信号，从而实现产品的待机和唤醒功能。

该模块的详细功能及开关机逻辑描述请参考《Hi3516DV300 专业型 Smart IP Camera SoC 用户指南》3.10 “电源管理与低功耗模式” 章节。

### 1.1.4.2 电路设计

PMC 模块供电管脚为 AVDD\_BAT、DVDD3318\_PC。

- AVDD\_BAT: RTC 模块供电电源，供电范围 1.6V~3.6V。使用常电区功能时，该管脚必须接电池或其他不掉电的电源。
- DVDD3318\_PC: 常电区的 1.8V 或 3.3V 电源。

对 PMC 模块进行硬件设计时，还有以下管脚需要注意：

- PWR\_RSTN: PMC 模块复位管脚，低电平有效。该管脚上必须设计一个 RC 复位电路，电阻和电容的选型请参考 HI3516DV300DMEB 原理图设计文件。
- 使用 PMC 模块来实现 HI3516DV300 的待机、唤醒功能时，由于 PMC 模块的工作时钟来自 RTC 模块，所以使用 PMC 功能时，RTC 模块必须供电，RTC 电路也必须正常设计。
- PWR\_BUTTON 用于对接开机按键，PWR\_STARTUP 上升沿可触发开机，PWR\_SEQ0/PWR\_SEQ1 用于使能需要受控的 DC-DC 或 LDO，PWR\_EN 用于使能 WIFI 或 BT 模块等需要待机工作的模块，PWR\_WAKEUP 用于接收唤醒信号。

### 1.1.4.3 待机场景下 RTC&PMC 的电源方案

在不同的待机工作状态下，RTC 和 PMC 有如下几种组合，不同组合下电源的接法建议方案如表 1-3 所示。

表1-3 不同待机工作状态下 RTC 和 PMC 电源方案

方案	工作状态		电源管脚处理方式	
	RTC	PMC/GPIO	AVDD_BAT	DVDD3318_PC
方案 1	不使用	不使用	悬空	DVDD3318_PC 接数字 1.8V 或 3.3V 电源
方案 2	不使用	使用 GPIO	悬空	DVDD3318_PC 接数字 1.8V 或 3.3V 电源
方案 3	使用	不使用	接电池（电压不超过 3.6V）或者其他不下电的电源	DVDD3318_PC 接数字 1.8V 或 3.3V 电源



方案	工作状态		电源管脚处理方式	
	RTC	PMC/GPIO	AVDD_BAT	DVDD3318_PC
方案 4	使用	使用 GPIO	接电池（电压不超过 3.6V）或者其他不下电的电源	DVDD3318_PC 接数字 1.8V 或 3.3V 电源
方案 5	使用	使用 PMC	AVDD_BAT 和 DVDD3318_PC 接不下电的 1.8V 或 3.3V 电源	

### 注意

在表 1-3 中：

- 方案 1 和 3：PWR\_BUTTON、PWR\_RSTN、PWR\_SEQ0、PWR\_EN、PWR\_STARTUP 和 PWR\_WAKEUP 可悬空。
- 方案 2 和 4：PWR\_BUTTON、PWR\_RSTN 和 PWR\_STARTUP 可悬空
- 方案 5：在使用 PMC 功能时，RTC 电路必须正常设计。

## 1.1.5 HI3516DV300 硬件初始化系统配置电路

Hi3516DV300 上电初始化的过程中，需要根据配置管脚的上下拉电阻状态来确定各部分的工作模式。硬件配置信号描述如下表 1-4 所示。

表1-4 信号描述

信号名	方向	说明
TEST_MODE	I	功能模式和测试模式选择。 0：功能模式； 1：测试模式。
BOOT_SEL[1:0]	I	BOOT 源的选择。 00：从 SPI Nor/Nand Flash 启动； 01：从 EMMC 启动； 10：FAST BOOT，串口烧写 SPI Nor/Nand Flash； 11：FAST BOOT，串口烧写 EMMC。
SFC_DEVICE_MODE	I	SPI FLASH 器件选择 0：SPI NOR FLASH 1：SPI NAND FLASH
SFC_BOOT_MODE	I	如果 BOOT_SEL[1:0]=00， SFC_DEVICE_MODE=0， SFC_BOOT_MODE 的状态表明了 SPI NOR



信号名	方向	说明
		FLASH 的 boot 模式选择。 0: 3 Byte address mode 1: 4 Byte address mode 如果 BOOT_SEL[1:0]=00, SFC_DEVICE_MODE=1, SFC_BOOT_MODE 的状态表明了 SPI NAND FLASH 的 boot 模式选择。 0: 1 I/O boot mode 1: 4 I/O boot mode
UPDATE_MODE	I	SDIO0 及 USB 烧写功能控制 0: 使能 SDIO0 及 USB 烧写功能; 1: 禁用 SDIO0 及 USB 烧写功能。 注: 使能 SDIO0 及 USB 烧写功能之后, BOOT_SEL[1:0]和 SFC_DEVICE_MODE 指定的 启动方式不生效。芯片在上电启动时, 会检测是 否有 SDIO0 接口上的 SD 卡或是否有 USB 存储设 备存在。如果有 SDIO0 接口上的 SD 卡或有 USB 存储设备存在, 会将 SD 卡或 USB 存储设备中存 放的 boot 烧写至 BOOT_SEL[1:0]和 SFC_DEVICE_MODE 指定的启动介质中。 SDIO1 不支持该功能。

#### 注意

表 1-4 中所列的系统配置管脚有部分与 RMII、Sensor、SFC 复用。如果这些管脚和外设器件的信号管脚有连接, 那么必须在该信号上设计上下拉电阻来确定配置管脚的初始状态, 电阻阻值推荐 4.7k $\Omega$ 。

## 1.1.6 DDR 电路设计

### 1.1.6.1 接口介绍

- Hi3516DV300 DDRC 接口支持 DDR3(L)/DDR4。
- 主芯片有 1 个 DDRC, 32bit 数据位宽, 可对接 2PCS 16bit 位宽 DDR3(L)/DDR4 颗粒。
- 具体规格请参考《Hi3516DV300 专业型 Smart IP Camera SoC 用户指南》第 4 章节的内容。



### 1.1.6.2 DDR 拓扑结构

对接双颗粒 DDR3(L)/DDR4 时，为了使 PCB layout 方便，根据不同的拓扑结构采用不同的线序，管脚的 SWAP 信息如表 1-5 所示。

表1-5 管脚 SWAP 信息

pin num	pin name	信号名			
		DDR3(L) T 型拓扑	DDR3(L) flyby 型拓扑	DDR4 T 型拓扑	DDR4 flyby 型拓扑
A7	DDR_A0	DDR3_A0	DDR3_BA1	DDR4_A4	DDR4_A15
A8	DDR_A1	DDR3_A1	DDR3_A4	DDR4_A3	DDR4_BA1
B9	DDR_A2	DDR3_A9	DDR3_A5	DDR4_A1	DDR4_A1
B7	DDR_A3	DDR3_A3	DDR3_A12	DDR4_A15	DDR4_A10
A9	DDR_A4	DDR3_A4	DDR3_A6	DDR4_BA1	DDR4_A5
B8	DDR_A5	DDR3_A2	DDR3_A1	DDR4_BA0	DDR4_A3
A10	DDR_A6	DDR3_A8	DDR3_A11	DDR4_A6	DDR4_A9
B11	DDR_A7	DDR3_A7	DDR3_A13	DDR4_A13	DDR4_A7
A11	DDR_A8	DDR3_A6	DDR3_A14	DDR4_A11	DDR4_A13
B10	DDR_A9	DDR3_A5	DDR3_A8	DDR4_A7	DDR4_A6
B5	DDR_A10	DDR3_A15	DDR3_A10	DDR4_A16	DDR4_ACT_N
D10	DDR_A11	DDR3_A11	DDR3_A9	DDR4_A5	DDR4_A8
C6	DDR_A12	DDR3_A12	DDR3_CAS_N	DDR4_A10	DDR4_A16
C11	DDR_A13	DDR3_A13	DDR3_A7	DDR4_A8	DDR4_A11
C10	DDR_A14	DDR3_A14	DDR3_A2	DDR4_A9	DDR4_A2
C9	DDR_A15	DDR3_A12	DDR3_A0	DDR4_A2	DDR4_A0
D7	DDR_BA0	DDR3_BA0	DDR3_BA0	DDR4_BG0	DDR4_A4
C8	DDR_BA1	DDR3_BA1	DDR3_A3	DDR4_A0	DDR4_BA0
C7	DDR_BA2	DDR3_BA2	DDR3_BA2	DDR4_A12	DDR4_BG0
B6	DDR_CASN	DDR3_CAS_N	DDR3_A15	DDR4_A14	DDR4_A14
A6	DDR_RASN	DDR3_RAS_N	DDR3_WE_N	DDR4_ACT_N	DDR4_A12
C5	DDR_WEN	DDR3_WE_N	DDR3_RAS_N	--	--
A4	DDR_CKE	DDR3_CKE	DDR3_CKE	DDR4_CKE	DDR4_CKE
A5	DDR_CSN	DDR3_CS_N	DDR3_CS_N	DDR4_CS_N	DDR4_CS_N
B4	DDR_ODT	DDR3_ODT	DDR3_ODT	DDR4_ODT	DDR4_ODT





pin num	pin name	信号名			
		DDR3(L) T 型拓扑	DDR3(L) flyby 型拓扑	DDR4 T 型拓扑	DDR4 flyby 型拓扑
C12	DDR_RESE TN	DDR3_RESET_N	DDR3_RESET_N	DDR4_RESET_N	DDR4_RESET_N
D12	DDR_ZQ	DDR_ZQ	DDR_ZQ	DDR_ZQ	DDR_ZQ
E5	ZQ1	ZQ1	ZQ1	ZQ1	ZQ1
B12	ZQ2	ZQ2	ZQ2	ZQ2	ZQ2
H1	DDR_DQ0	DDR3_DQ6	DDR3_DQ6	DDR4_DQ6	DDR4_DQ0
H2	DDR_DQ1	DDR3_DQ2	DDR3_DQ2	DDR4_DQ4	DDR4_DQ4
J2	DDR_DQ2	DDR3_DQ13	DDR3_DQ9	DDR4_DQ14	DDR4_DQ10
J1	DDR_DQ3	DDR3_DQ11	DDR3_DQ15	DDR4_DQ0	DDR4_DQ14
K3	DDR_DQ4	DDR3_DQ9	DDR3_DQ13	DDR4_DQ12	DDR4_DQ8
L4	DDR_DQ5	DDR3_DQ0	DDR3_DQ0	DDR4_DQ8	DDR4_DQ12
L3	DDR_DQ6	DDR3_DQ15	DDR3_DQ11	DDR4_DQ10	DDR4_DQ2
L2	DDR_DQ7	DDR3_DQ4	DDR3_DQ4	DDR4_DQ2	DDR4_DQ6
M3	DDR_DQ8	DDR3_DQ1	DDR3_DQ7	DDR4_DQ15	DDR4_DQ7
N3	DDR_DQ9	DDR3_DQ3	DDR3_DQ1	DDR4_DQ11	DDR4_DQ3
P4	DDR_DQ10	DDR3_DQ5	DDR3_DQ10	DDR4_DQ5	DDR4_DQ11
N2	DDR_DQ11	DDR3_DQ8	DDR3_DQ14	DDR4_DQ1	DDR4_DQ13
N1	DDR_DQ12	DDR3_DQ12	DDR3_DQ12	DDR4_DQ3	DDR4_DQ9
P3	DDR_DQ13	DDR3_DQ7	DDR3_DQ8	DDR4_DQ7	DDR4_DQ15
P1	DDR_DQ14	DDR3_DQ14	DDR3_DQ3	DDR4_DQ9	DDR4_DQ1
P2	DDR_DQ15	DDR3_DQ10	DDR3_DQ5	DDR4_DQ13	DDR4_DQ5
A2	DDR_DQ16	DDR3_DQ21	DDR3_DQ22	DDR4_DQ19	DDR4_DQ20
B2	DDR_DQ17	DDR3_DQ20	DDR3_DQ29	DDR4_DQ23	DDR4_DQ26
B1	DDR_DQ18	DDR3_DQ23	DDR3_DQ25	DDR4_DQ21	DDR4_DQ30
C3	DDR_DQ19	DDR3_DQ19	DDR3_DQ18	DDR4_DQ31	DDR4_DQ24
D3	DDR_DQ20	DDR3_DQ18	DDR3_DQ31	DDR4_DQ22	DDR4_DQ28
D2	DDR_DQ21	DDR3_DQ22	DDR3_DQ20	DDR4_DQ18	DDR4_DQ22
E3	DDR_DQ22	DDR3_DQ30	DDR3_DQ27	DDR4_DQ20	DDR4_DQ16
F4	DDR_DQ23	DDR3_DQ16	DDR3_DQ16	DDR4_DQ26	DDR4_DQ18
F1	DDR_DQ24	DDR3_DQ28	DDR3_DQ28	DDR4_DQ25	DDR4_DQ29



pin num	pin name	信号名			
		DDR3(L) T 型拓扑	DDR3(L) flyby 型拓扑	DDR4 T 型拓扑	DDR4 flyby 型拓扑
F2	DDR_DQ25	DDR3_DQ17	DDR3_DQ30	DDR4_DQ27	DDR4_DQ25
G1	DDR_DQ26	DDR3_DQ26	DDR3_DQ26	DDR4_DQ28	DDR4_DQ21
G2	DDR_DQ27	DDR3_DQ27	DDR3_DQ21	DDR4_DQ30	DDR4_DQ17
H3	DDR_DQ28	DDR3_DQ24	DDR3_DQ24	DDR4_DQ17	DDR4_DQ23
H4	DDR_DQ29	DDR3_DQ29	DDR3_DQ23	DDR4_DQ29	DDR4_DQ19
J3	DDR_DQ30	DDR3_DQ25	DDR3_DQ17	DDR4_DQ16	DDR4_DQ27
J4	DDR_DQ31	DDR3_DQ31	DDR3_DQ19	DDR4_DQ24	DDR4_DQ31
N4	DDR_DM0	DDR3_DM0	DDR3_DM0	DDR4_DM0	DDR4_DM0
M4	DDR_DM1	DDR3_DM1	DDR3_DM1	DDR4_DM1	DDR4_DM1
G3	DDR_DM2	DDR3_DM2	DDR3_DM2	DDR4_DM2	DDR4_DM2
F3	DDR_DM3	DDR3_DM3	DDR3_DM3	DDR4_DM3	DDR4_DM3
K2	DDR_DQS0_N	DDR_DQS0_N	DDR3_DQS0_N	DDR4_DQS0_N	DDR4_DQS0_N
K1	DDR_DQS0_P	DDR_DQS0_P	DDR3_DQS0_P	DDR4_DQS0_P	DDR4_DQS0_P
M2	DDR_DQS1_N	DDR_DQS1_N	DDR3_DQS1_N	DDR4_DQS1_N	DDR4_DQS1_N
M1	DDR_DQS1_P	DDR_DQS1_P	DDR3_DQS1_P	DDR4_DQS1_P	DDR4_DQS1_P
C2	DDR_DQS2_N	DDR_DQS2_N	DDR3_DQS2_N	DDR4_DQS2_N	DDR4_DQS2_N
C1	DDR_DQS2_P	DDR_DQS2_P	DDR3_DQS2_P	DDR4_DQS2_P	DDR4_DQS2_P
E2	DDR_DQS3_N	DDR_DQS3_N	DDR3_DQS3_N	DDR4_DQS3_N	DDR4_DQS3_N
E1	DDR_DQS3_P	DDR_DQS3_P	DDR3_DQS3_P	DDR4_DQS3_P	DDR4_DQS3_P
C4	DDR_CLK_N	DDR3_CLK_N	DDR3_CLK_N	DDR4_CLK_N	DDR4_CLK_N
D4	DDR_CLK_P	DDR3_CLK_P	DDR3_CLK_P	DDR4_CLK_P	DDR4_CLK_P

### 注意

DDR3(L)flyby 拓扑布局布线必须完全拷贝 HI3516DV300DMEB 的设计，DDR3(L) T 型拓扑布局布线必须完全拷贝 HI3516DV300DMEBPRO 的设计，DDR4 flyby 拓扑布局布线必须完全拷贝 HI3516DV300DDR4DMEB 的设计，DDR4 T 型拓扑必须完全拷贝 HI3516DV300DMEBLITE 的设计。相关的设计文件请见发布包中的硬件部分。

### 1.1.6.3 匹配方式设计建议

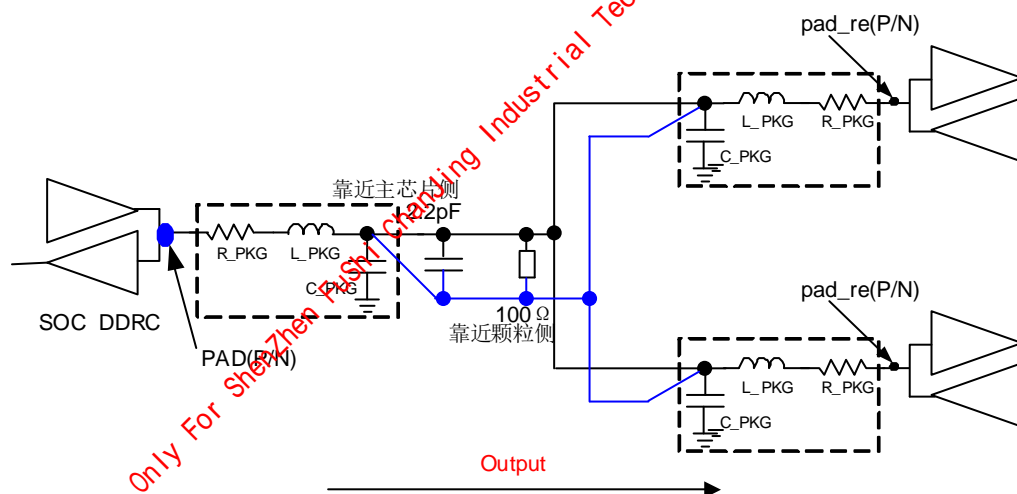
- DQ、DQS 双向信号：

Hi3516DV300 应用中 DQ、DQS\_P/N 信号都是点对点拓扑，直连即可。

- 差分时钟：

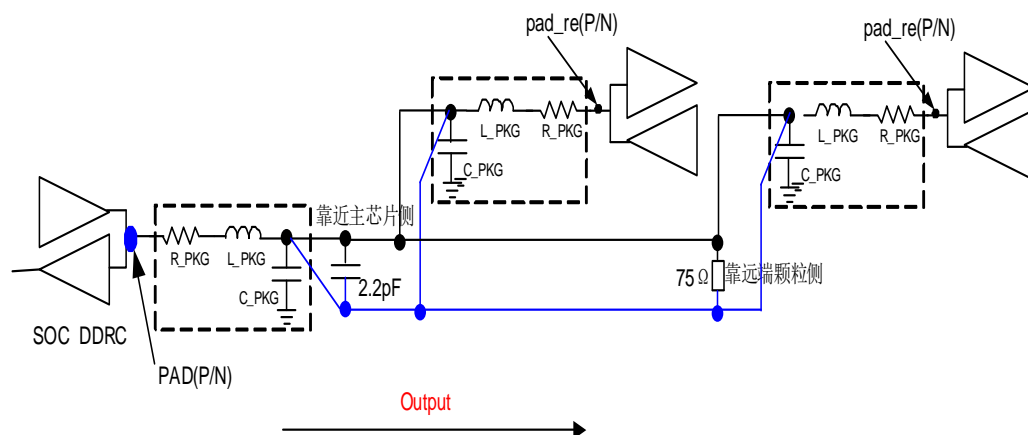
对接 DDR3(L)/DDR4 双颗粒 T 型拓扑时，DDR\_CLK\_N/P 采用一驱二拓扑，在靠近 SOC 端位置跨接 1 个 2.2pF 电容，在靠近颗粒端的位置跨接 1 个 100Ω 的电阻，如图 1-5 所示。

图1-5 DDR3(L)/DDR4（T型）差分时钟信号一驱二应用



- 对接 DDR3(L)/DDR4 双颗粒 flyby 型拓扑时，DDR\_CLK\_N/P 采用一驱二拓扑，在靠近 SOC 端位置跨接 1 个 2.2pF 电容，在靠近远端颗粒的位置跨接 1 个 75Ω 的电阻，如图 1-6 所示。

图1-6 DDR3(L)/DDR4 (flyby 型) 差分时钟信号一驱二应用

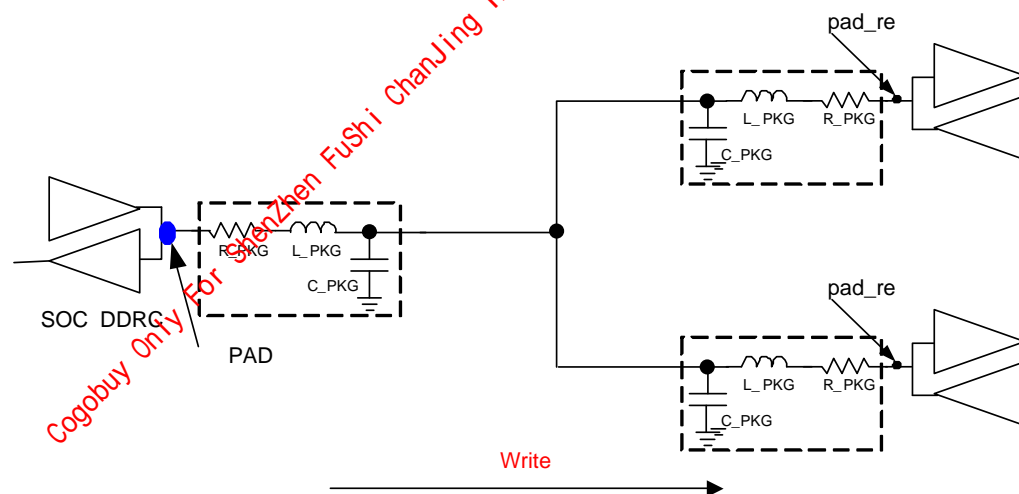


#### 1.1.6.4 地址信号和命令信号

Hi3516DV300 DDR 应用中:

- DDR3(L)/DDR4 T 型拓扑设计时, 地址和命令信号一驱二直连, 如图 1-7 所示。

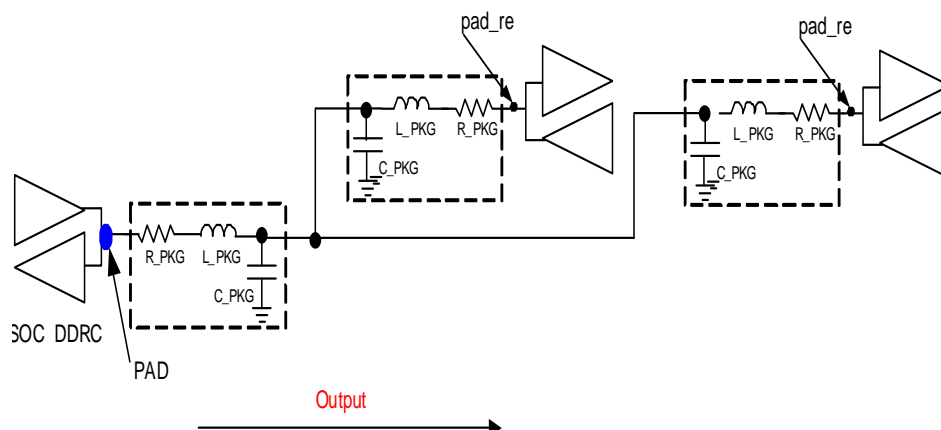
图1-7 DDR3(L)/DDR4 (T 型结构) 地址和命令信号一驱二应用



- 对接 2 颗 16bit 位宽 DDR3(L)/DDR4 颗粒 (flyby 型) 时, 地址和命令信号一驱二连接。匹配方式如下:
  1. 信号 DDR\_CS\_N 远端戴维南匹配;
  2. 信号 DDR\_CKE 远端戴维南匹配;
  3. 信号 DDR\_ODT 远端戴维南匹配;
  4. 其他信号一驱二直连。



图1-8 DDR3(L)/DDR4 (flyby 型) 地址和命令信号一驱二应用



### 1.1.6.5 数据掩码信号

DDR 应用中 DM0/DM1/DM2/DM3 信号都是点对点拓扑，直连即可。

### 1.1.6.6 DDR 颗粒外部电阻选择

外部电阻 (ZQ) 选择 240Ω，精度 ±1%。

## 1.1.7 FLASH 原理图设计

### 1.1.7.1 接口介绍

FLASH 控制器支持 SPI NOR FLASH、SPI NAND FLASH 和 eMMC。

### 1.1.7.2 信号处理

### SPI FLASH 设计

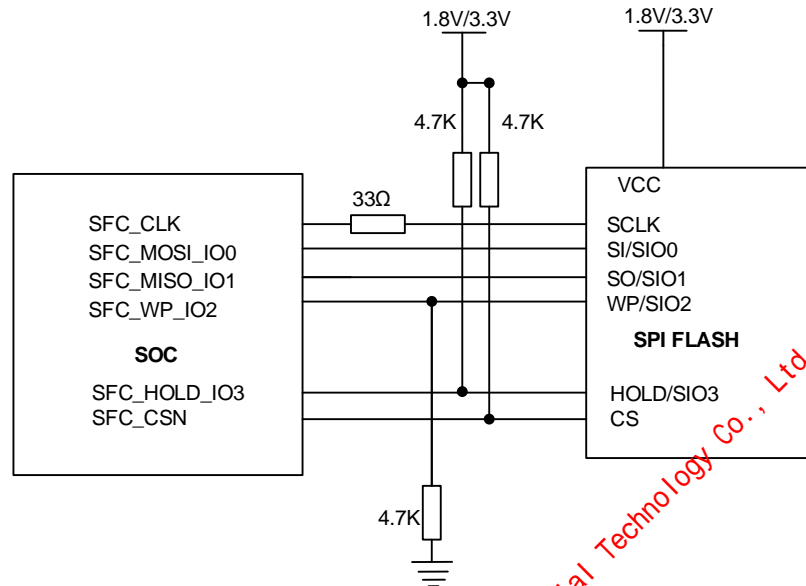
外接 SPI FLASH 时，SPI FLASH 匹配设计推荐如表 1-6 所示，连接方式推荐如图 1-9 所示。

表1-6 SPI FLASH 匹配设计方法

信号	设计方法
SFC_CLK	时钟一驱一，Hi3516DV300 源端串接 33Ω 电阻。信号走线长度不超过 3inch。
SFC_MOSI_IO0 SFC_MISO_IO1 SFC_WP_IO2 SFC_HOLD_IO3 SFC_CSN	直接相连，其中 SFC_WP_IO2 需要下拉，推荐下拉电阻阻值为 4.7kΩ；SFC_HOLD_IO3 和 SFC_CSN 需要上拉，推荐上拉电阻阻值为 4.7kΩ。 数据一驱一，信号走线长度不超过 1.5inch 时直连，走线长度超过 1.5inch 小于 3inch 时源端串 33ohm 电阻。



图1-9 SPI FLASH 连接示意图



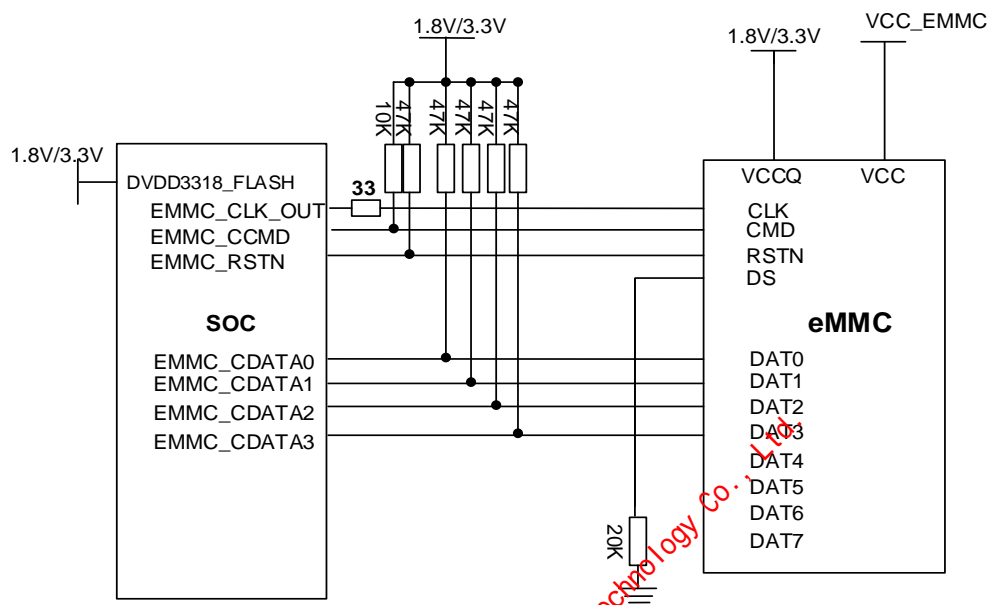
推荐选用带复位功能的 SPI FLASH 器件，以避免出现主芯片 Watch Dog 生效复位时，FLASH 无法同步复位，从而无法正常重启。

## eMMC 信号设计

外接 eMMC 设计时，eMMC 连接如图 1-10 所示。



图1-10 eMMC 连接示意图



匹配设计推荐如表 1-7 所示。

表1-7 eMMC 匹配设计方法

信号	设计方法
EMMC_CLK	Hi3516DV300 端串联 33Ω 电阻。信号走线长度不超过 2.5inch。
EMMC_DATA[0:3]	直接相连，并且需要接上拉电阻，阻值推荐 47kΩ。 信号走线长度不超过 2.5inch。
EMMC_CMD	直接相连，并且需要接 10kΩ 上拉电阻。 信号走线长度不超过 2.5inch。
EMMC_RST_N	直接相连，并且需要接 47kΩ 上拉电阻。

### 注意

EMMC\_RST\_N 管脚与 SYS\_RST\_N 管脚复用，当用作 EMMC\_RST\_N 功能时，外设复位使用其他 GPIO 进行复位。



## 1.2 电源设计建议

Hi3516DV300 芯片电源设计参数请参见《Hi3516DV300 专业型 Smart IP Camera SoC 用户指南》电性能参数章节。

Hi3516DV300 的电源设计，要求完全拷贝 HI3516DV300DMEB 的原理图设计。

### 1.2.1 CORE 电源设计

Hi3516DV300 的 CORE 电源 DVDD，典型电压 0.9V，实际电压由 SVB 动态调压电路控制，具体参考 HI3516DV300DMEB 最新原理图。电源芯片选型要求其供电能力不小于 3A 规格设计，建议使用**支持 COT 模式**的 DCDC。

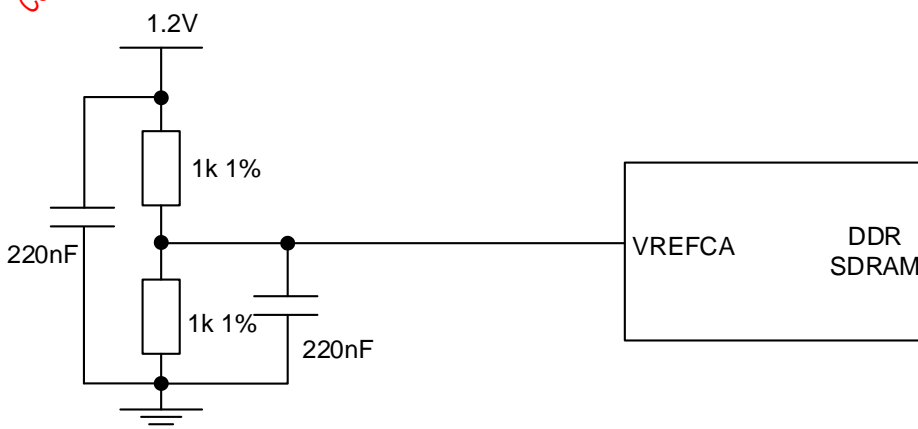
该电源要求在芯片端的纹波噪声控制在 $\pm 38\text{mV}$  以内。

### 1.2.2 DDR 电源设计

- Hi3516DV300 支持 DDR3(L)/DDR4，典型电压 1.5V(1.35V)/1.2V，参考电压（Vref）等于  $1/2 \text{ VDDIO\_DDR}$ 。DDR 颗粒的电源要求与 Hi3516DV300 的 DDR IO 电源采用同一电源网络供电。
- 要求单板上采用单独的供电芯片给 DDR 颗粒和 Hi3516DV300 DDR IO 电源管脚（管脚名 VDDIO\_DDR）供电。
- DDR PLL 电源（管脚名 AVDD33\_DDR\_PLL）：连接 3.3V 电源。必须使用磁珠（ $1\text{k}\Omega @ 100\text{MHz}$ ）和主芯片的数字 3.3V 电源进行隔离。
- 主芯片的 DDRIO 的 CK 电源供电（管脚名为 VDDIO\_DDR\_CK）必须使用磁珠（ $1\text{k}\Omega @ 100\text{MHz}$ ）和 VDDIO\_DDR 电源进行隔离。
- 通过  $1\text{k}\Omega$  电阻（精度  $\pm 1\%$ ）分压为 DDR 颗粒的 Vref 供电。
- Hi3516DV300 主芯片的 Vref 电源集成到内部，外部无需做相应的设计。
- 要求使用**固定 PWM 模式**的 DCDC。

DDR4 VREF 电源参考设计如图 1-11 所示。

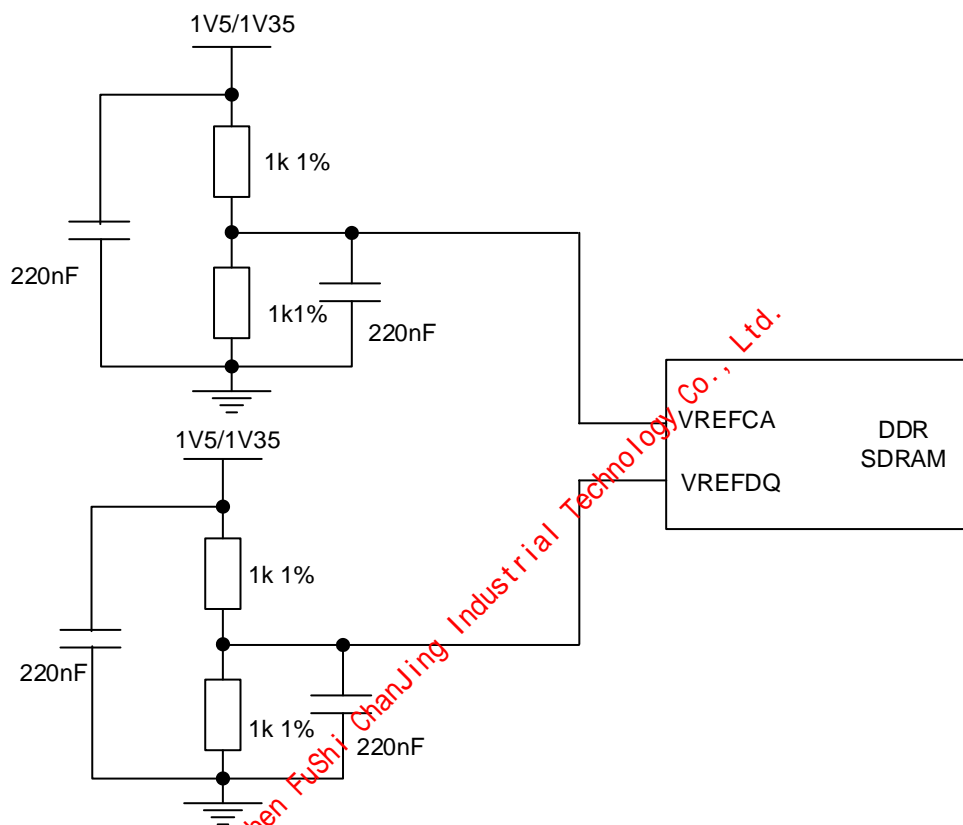
图1-11 DDR4 电源分压网络参考设计





DDR3(L) VREF 电源参考设计如图 1-12 所示。

图1-12 DDR3(L)电源分压网络参考设计



### 注意

DDR4 颗粒需要 2.5V 的供电电源 VPP，VPP 电源必须先于或同时与 1.2V VDD 电源上电，且无论什么时候 VPP 电源幅值必须大于等于 1.2V VDD 电源幅值。

## 1.2.3 IO 电源设计

- IO 电源（管脚名 DVDD33）：连接数字 3.3V 电源，建议客户使用**固定 PWM 模式**的 DCDC。
- FLASH 接口 IO 电源（DVDD3318\_FLASH）：支持 3.3V/1.8V，实际连接的电源要与对接芯片的接口电平保持一致。
- Sensor 时钟、复位和配置管脚 IO 电源（管脚名 DVDD3318\_SENSOR）：支持 3.3V/1.8V 电源，实际连接的电源要与对接芯片的接口电平保持一致。
- MIPI/LVDS 接口电源（管脚名 AVDD3318\_MIPI）：支持 3.3V/1.8V 电源。

Hi3516DV300 的 MIPI/LVDS 管脚可以复用成 Parallel Data 功能，电平支持 3.3V/1.8V，实际连接的电源要与对接芯片的接口电平保持一致。



当使用 MIPI 或者 LVDS 模块时，AVDD3318\_MIPI 必须连接 1.8V 电源。

当 MIPI/LVDS 管脚复用为 Parallel Data 功能时，AVDD3318\_MIPI 连接 3.3V/1.8V。

- VI 接口电源（管脚名 DVDD3318\_VI）：支持 3.3V/1.8V 电源。

Hi3516DV300 的 VI 管脚可以复用为 Parallel Data 功能和 MIPI/LVDS 管脚上复用的 Parallel Data 接口组成 16bit 的 BT1120 输入接口，或组成最高支持 14bit 的 Parallel Data 输入接口。实际连接的电源要与对接芯片的接口电平保持一致。

VI 管脚可独立复用成 VI BT.656 接口。

VI 管脚可独立复用成 VO BT.656 接口。

- UART1 接口电源（管脚名 DVDD3318\_UART1）：支持 3.3V/1.8V 电源。
- SDIO1 接口电源(管脚名 DVDD3318\_SDIO1)：支持 3.3V/1.8V 电源。
- 常电区供电电源(管脚名 DVDD3318\_PC)：支持 3.3V/1.8V 电源。

## 1.2.4 PLL 电源设计

Hi3516DV300 的 PLL 电源有 2 个，分别是：

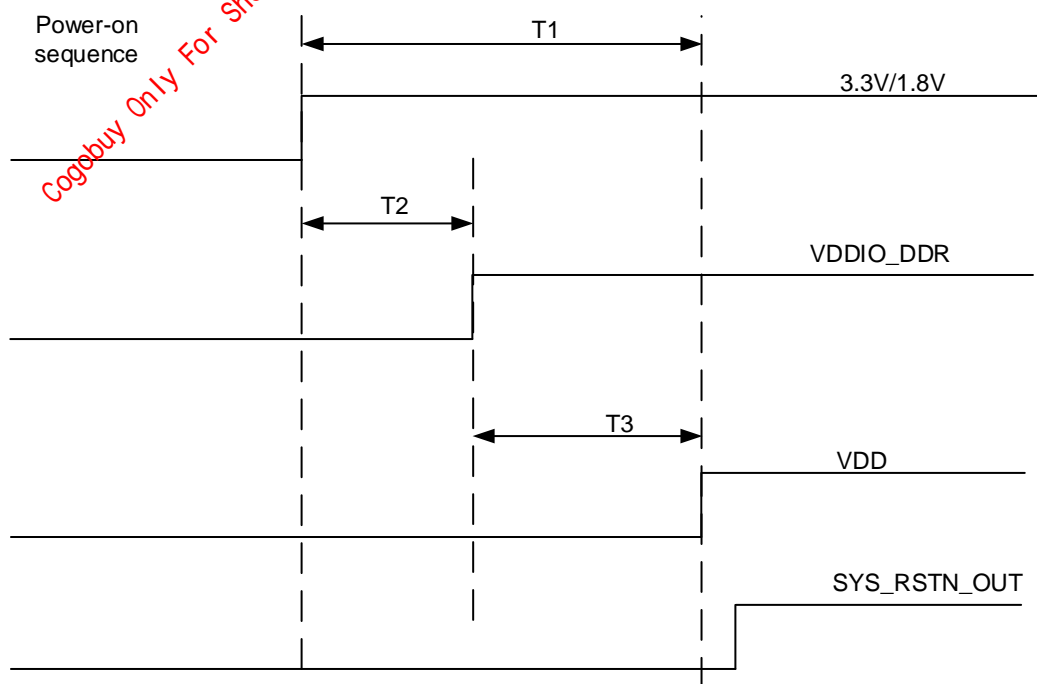
- AVDD09\_PLL：设计上必须用磁珠（ $1k\Omega @ 100MHz$ ）对 DVDD 电源进行隔离。
- AVDD33\_PLL：设计上必须用磁珠（ $1k\Omega @ 100MHz$ ）对数字 3.3V 电源进行隔离。

具体电路设计请参考 HI3516DV300DMEM 板原理图。

## 1.2.5 上下电时序

Core 电源、DDR 电源和 IO 电源有上下电时序的要求，如图 1-13 和图 1-14 所示。

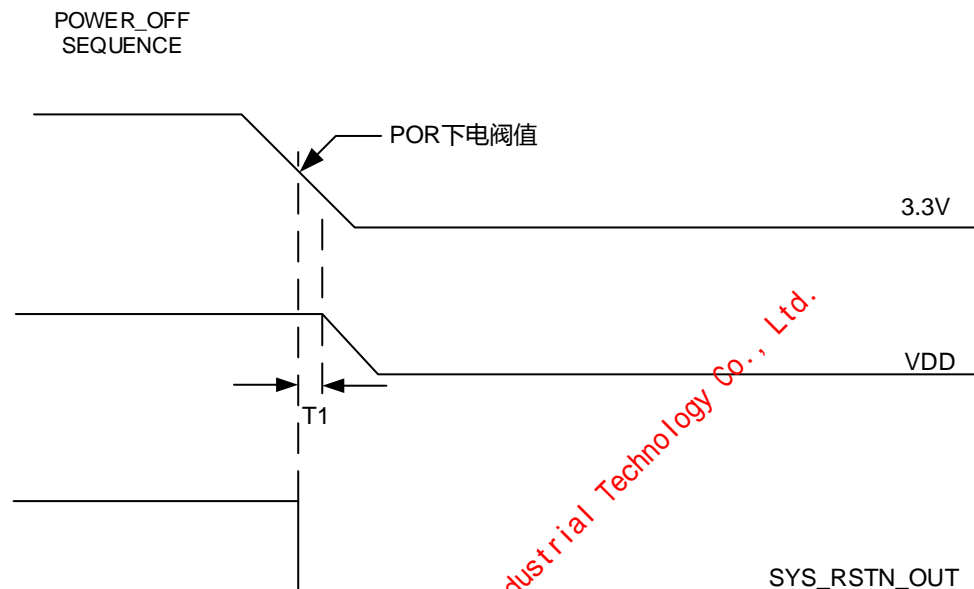
图1-13 上电时序图





其中,  $0 < T1 \leq 10\text{ms}$ ,  $T2 \geq 0\text{ms}$ ,  $T3 > 0\text{ms}$ 。上电顺序从先往后依次排列顺序为 3.3V/1.8V、DDRIO、Core 电源。

图1-14 下电时序图



其中,  $T1 > 0$ 。

下电时, 3.3V/1.8V 先下电, 当 3.3V 电源电平下降到 POR 阈值 2.1V 时, 触发 POR 复位, CORE 电源才可以开始下电。

### 注意

POR 模块对应的电源管脚是 DVDD33 (P17、H17、V8 pin)。

POR 的上电阈值是 2.6V, 下电阈值是 2.1V。下电时, POR 有三种工作状态:

- DVDD33 的电压由 3.3V 下降至 2.6V。从此时开始计时, 如果在 5us 时刻, DVDD33 的电压大于 2.6V, POR 不触发复位, SYS\_RSTN\_OUT 管脚保持高电平。
- DVDD33 的电压由 3.3V 下降至 2.6V。从此时开始计时, 如果在 5us 时刻, DVDD33 的电压小于或等于 2.6V, 且大于 2.1V, 那么 POR 触发复位, SYS\_RSTN\_OUT 管脚输出低电平。
- DVDD33 的电压由 3.3V 下降至 2.6V。从此时开始计时, 如果在 5us 之内, DVDD33 的电压小于或等于 2.1V, POR 直接触发复位, SYS\_RSTN\_OUT 管脚输出低电平。

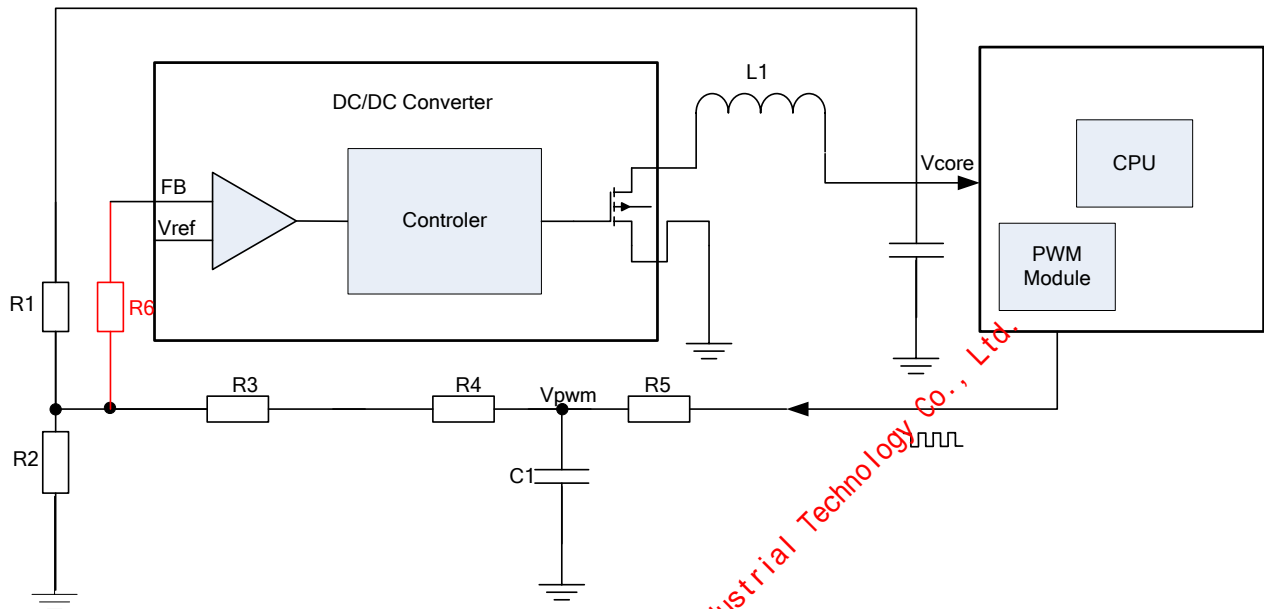
## 1.2.6 SVB 动态调压

Hi3516DV300 的 Core 电源必须增加动态调压功能, 实现方式如下:

通过 Hi3516DV300 的 PWM 波形输出管脚 SVB\_PWM, 经过 RC 滤波后输出 0~3.3V 不同电压的直流电平, 该直流电平经电阻网络叠加到 DC-DC 的反馈电压输入处, 实现

DC-DC 输出电压的调节。调节 Hi3516DV300 相关的寄存器可以改变 PWM 的频率和占空比，最终可以实现动态调节 DC-DC 的输出电压，如图 1-15 所示。

图1-15 电源动态调压示意图



SVB 电路设计中，将 Hi3516DV300 SVB\_PWM 管脚通过 SVB 电路连接至 CORE 电源 DCDC 的 FB 管脚即可。设计中需注意事项如下：

- PWM 用于控制 DVDD 电源的电压；
- Hi3516DV300 的 1.3V 电源直流电压值误差范围不要超过  $\pm 50\text{mV}$ ；
- DCDC 的 FB 管脚前预留一个电阻 R6，用于调节 DCDC 器件的环路稳定性；通常 R6 的阻值可以按照下面的规则进行计算。该计算方法仅适用 MPS 的 DCDC，其他方案 DCDC，需客户与厂家确认。

$$R6 * (Vout/Vref) + R1 = 200k$$

其中，Vout 是 DCDC 输出的标称电压值，Vref 是 DCDC 的参考电压值，R1 是 DCDC FB 管脚的上分压电阻值。

等式右边的 200k 是一个经验值，当 DCDC 输出电容容值大于 DCDC 手册中的参考电容容值，那么这里可以改为 100k。

计算出来的 R6 是一个参考值，实际阻值可以在计算值左右波动，尽量接近即可。

- 要求选用 DC-DC 参考电压 Vref 小于 0.65V，DCDC 的 Vref 精度偏差不能超过 2%。



### 注意

所有的电阻精度均要求 1%，电容材质必须为 X7R 或 X7S。

SVB 电路的参数配置必须保持与表 1-8 一致。

表1-8 DVDD SVB 调压 RC 参数

Vref(V)	R1(kohm)	R2(kohm)	R3(kohm)	R4(kohm)	R5(kohm)	C(uF)
0.45	24	20	120	47	1	2.2
0.6	15	24	100	20	1	2.2
0.608	15	24	120	24	1	2.2

## 1.3 外围接口设计建议

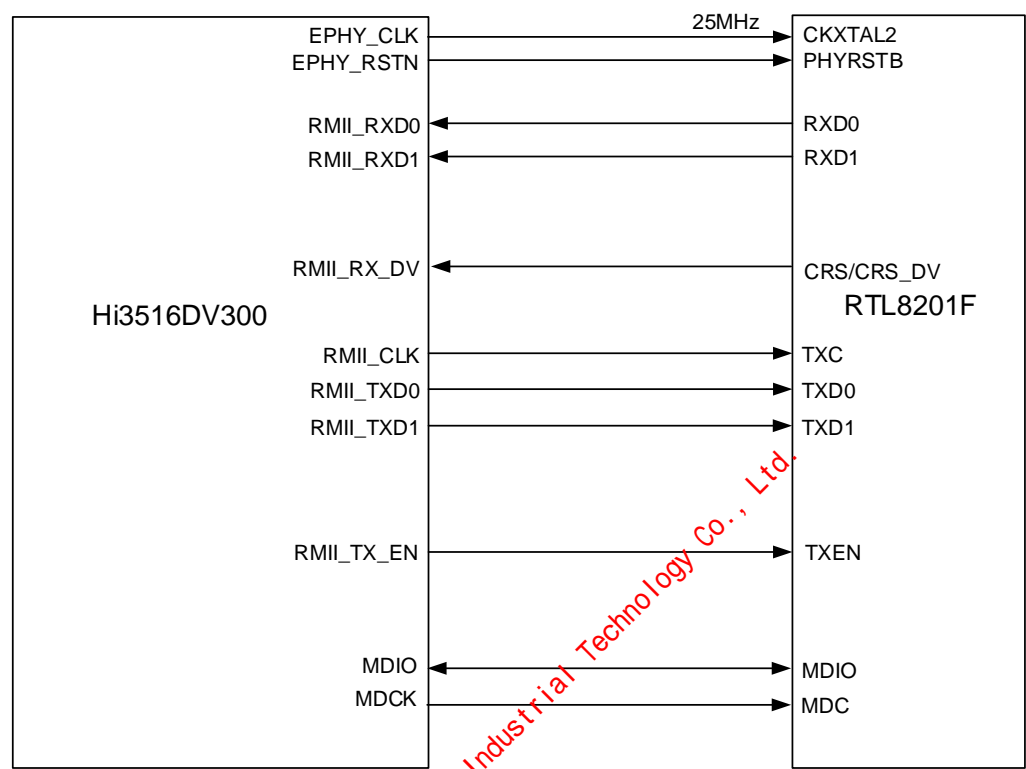
### 1.3.1 MAC 接口

#### MAC 接口设计

Hi3516DV300 的 MAC 支持 RMII 模式，不支持 RGMII 和 MII 模式。各模式的信号连接如图 1-16 所示。



图1-16 Hi3516DV300 RMII 模式下的信号连接示意图



ETH MAC 信号设计要求如表 1-9 所示。

表1-9 ETH MAC 信号设计方法

信号	设计方法
RMII_CLK	信号在 Hi3516DV300 端串联 33Ω 电阻，走线长度不能超过 8inch。
RMII_TXD[0:1] RMII_TX_EN	信号直连，走线长度不能超过 8inch。
RMII_RXD[0:1] RMII_RX_DV	信号直连，走线长度不能超过 8inch。
MDCK	信号在 Hi3516DV300 端串联 33Ω 电阻，走线长度不能超过 8inch。
MDIO	信号直连，走线长度不能超过 8inch，接 1.5kΩ 上拉电阻。
EPHY_CLK	信号在 Hi3516DV300 端串联 33Ω 电阻，走线长度不能超过 8inch。



### 注意

若选用的 FEPHY 需要外供工作时钟，除使用芯片 EPHY\_CLK 供给之外，需要预留外部晶振方案。

## 1.3.2 音视频接口

### 1.3.2.1 模拟音频接口设计

Hi3516DV300 提供 1 组双声道音频输入接口 (AC\_INL/R)，1 组双声道输出接口 (AC\_OUTL/R)。

AC\_INL/R 可以复用为一个差分输入接口 AC\_IN\_P/N。音频输出接口不支持差分输出。

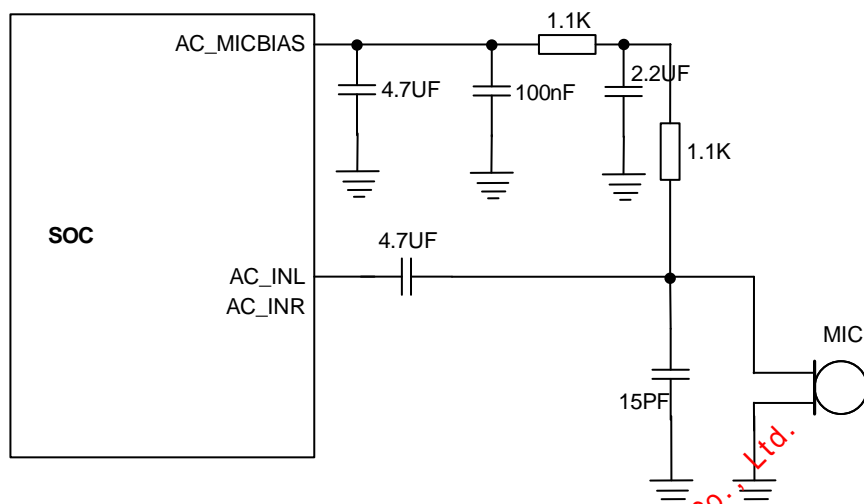
- Audio 模块的模拟电源 AVDD33\_AC 必须使用磁珠与系统 3.3V 电源隔离。
- AC\_VREF 引脚上的滤波电容 4.7uF+100nF 的低 ESR 陶瓷电容。
- Audio 模块的输入接口均可作为 LINEIN 或者 MIC\_IN 的输入通道。如果输入设备为无源 MIC，则需要提供 MIC\_BIAS 偏置电压。如果输入设备为有源 LINE 输出设备（例如：PC），则不需要。
- 音频输入信号上的隔直电容靠近 Hi3516DV300 放置，电容容值推荐选择 4.7uF。
- Hi3516DV300 提供了 1 个 MIC\_BIAS 管脚，AC\_MICBIAS 管脚处需要放置一个 4.7uF 电容。
- 为获得较好的音频质量，建议在音频输出管脚 AC\_OUTL 和 AC\_OUTR 的外围增加音频放大器以及滤波电路。
- 音频输出信号线上必须有 ESD 保护措施，加强接口的抗干扰能力。

### MIC 单端输入电路设计

MIC 单端输入参考电路如图 1-17 所示：



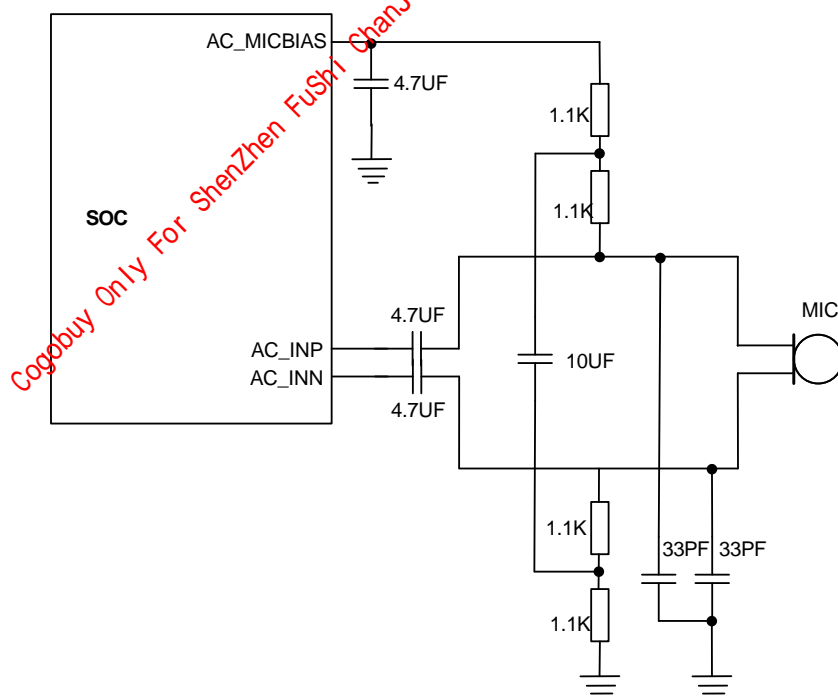
图1-17 MIC 单端输入电路



## MIC 差分输入电路设计

MIC 差分输入参考电路如图 1-18 所示，图中使用的 MIC 为普通单端 MIC。

图1-18 MIC 差分输入电路







### 注意

Audio 模块容易受电源噪声和信号串扰影响，为了有效降低音频底噪，需要根据使用场景做以下处理：

#### 1、场景一（单 MIC）

- 推荐 MIC 输入电路采用差分设计，MIC 可选用普通单端 MIC；
- 若单 MIC 单端输入，需要限制输入增益，且未接 MIC 通路需要寄存器关闭，增益配置按照场景二的方法处理。

#### 2、场景二（双 MIC）

- MIC 输入电路采用单端设计，这时建议通过限制输入增益或关闭 ADC 增益 Boost 控制的方式来降低底噪，推荐把输入增益调节到 40db 以下；如果对拾音或音质有更高要求，适当选用灵敏度更高的 MIC 或外置 codec。

以上两种方法都需要对相应寄存器进行设置，具体寄存器描述请参考《Hi3516DV300 专业型 Smart IP Camera SoC 用户指南》11.2 章节，寄存器调节方法请参考《Hi3516DV300 音频优化方案》。

## 1.3.2.2 I2S 接口

Hi3516DV300 支持 1 个 I2S 接口，与 JTAG 接口复用，图 1-19 和图 1-20 分别表示了“5 线模式” I2S 主模式和从模式的连接方式。

### 注意

I2S 和 Audio codec 共用通道，不能同时使用。

图1-19 “5 线模式” I2S 主模式连接方式

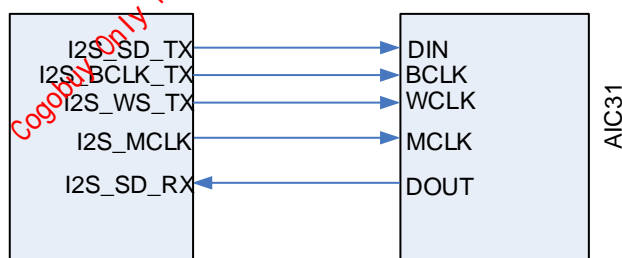
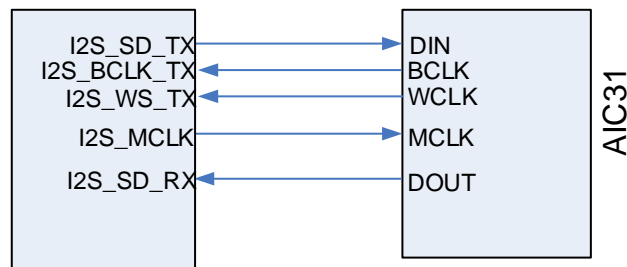


图1-20 “5 线模式” I2S 从模式连接方式



### 1.3.2.3 Sensor 配置接口设计

Hi3516DV300 最多支持 2 路 Sensor 输入，Sensor 的配置接口包含如下信号：

- SENSOR0/1\_RSTN、SENSOR0/1\_CLK、SENSOR\_HS、SENSOR\_VS。
- SPI0/I2C0/I2C1

各个信号的用途说明如下：

- SENSOR0/1\_RSTN 能通过配置寄存器输出复位信号，用于 Sensor 的复位。
- SENSOR0/1\_CLK 提供各种主流 Sensor 的工作时钟，详细请见《Hi3516DV300 专业型 Smart IP Camera SoC 用户指南》系统章节的 CRG 寄存器的配置信息。SENSOR0/1\_CLK 需要在 Hi3516DV300 端串联 33Ω 电阻。
- SPI0/I2C0 用于 Sensor 的配置：
  - 其中 I2C0/1\_SCL 和 SPI0\_SCLK 复用，I2C0/1\_SDA 与 SPI0\_SDO 复用，Sensor 配置接口还支持一种“3 Wire SPI Interface”，它也与 SPI0 复用，用于对接部分松下 Sensor。
  - 在设计时，I2C 信号需要外接上拉电阻，上拉电阻值必须为 1kΩ。
- SENSOR\_HS 和 SENSOR\_VS 输出行场同步信号，用于支持“从模式”的 Sensor。
- 为保证 ESD 性能，在 Sensor 板电路设计中，Sensor 复位信号需加入 1nF 对地电容。

对接 Sensor 时，推荐以下接法，如图 1-21 和图 1-20 所示：

图1-21 对接双 sensor 配置接口接法

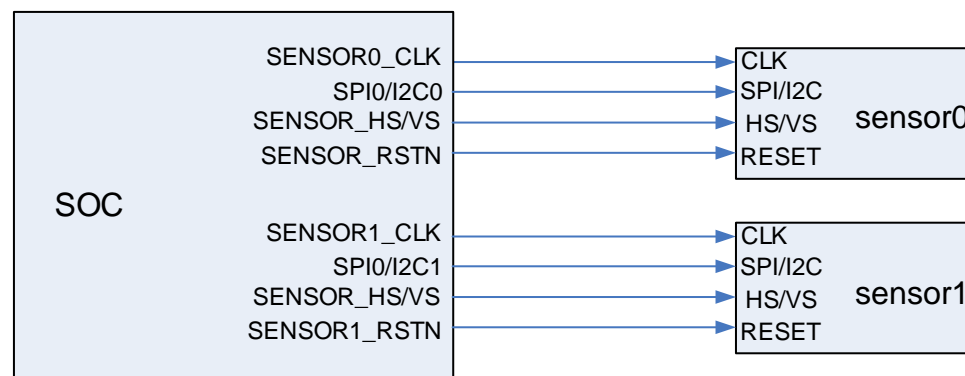
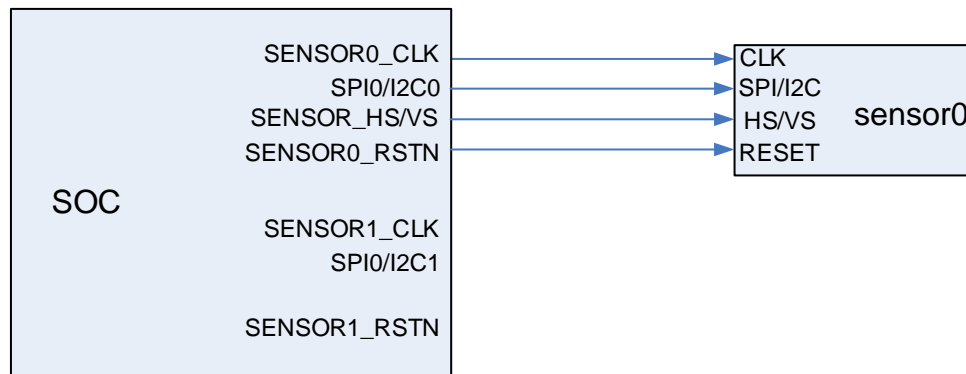




图1-22 对接单 sensor 配置接口接法



### 1.3.2.4 VI 接口设计

VI 可以复用为两种接口：Parallel CMOS 视频输入接口和差分视频输入接口（即 MIPI RX 接口）。

- Parallel CMOS 视频输入接口支持 RAW Data、BT.1120、BT.656、BT.601 格式的数据。接口频率可达 148.5MHz。
  - 当对接信号是 RAW DATA 时，单板设计时从 VI 低位开始按照顺序连接，例如 12bit RAW DATA 对接 VI 的 D0~D11 位。
  - 当对接信号是 BT.1120 时，单板设计时 Y 信号按顺序对接 VI 的高 8bit，C 信号按顺序对接 VI 的低 8bit。内同步和外同步方式均支持。
  - 当对接信号是 BT.656 或者 BT.601 时，单板设计时从 VI 低位开始按照顺序连接。
- 差分视频输入接口有 2 组差分时钟信号和 4 组差分数据信号，支持 2lane MIPI RX 输入和 4lane MIPI RX 输入。
  - 4lane MIPI RX 规格时，MIPI\_RX\_CK0P/N 对 MIPI\_RX\_D0P/N、MIPI\_RX\_D1P/N、MIPI\_RX\_D2P/N、MIPI\_RX\_D3P/N 进行采样。
  - 2lane MIPI RX 规格时，MIPI\_RX\_CK0P/N 对 4 lane 数据中的任意 2lane 进行采样，设计时建议优先选择 MIPI\_RX\_D0P/N 和 MIPI\_RX\_D2P/N。
  - 2lane+2lane MIPI RX 规格时，要求 MIPI\_RX\_CK0P/N 对 MIPI\_RX\_D0P/N、MIPI\_RX\_D2P/N 进行采样，MIPI\_RX\_CK1P/N 对 MIPI\_RX\_D1P/N、MIPI\_RX\_D3P/N 进行采样。
- MIPI RX 接口内置了 100Ω 跨接匹配电阻，外部无需再设计或者预留。
- VI 接口连接方式具体详见《Hi3516DV300 Sensor 输入接口电平场景详细说明.xlsx》。



### 注意

当使用非 MIPI RX 功能时，需要先配置 PHY\_MODE\_LINK 和 PHY\_EN\_LINK 寄存器分别为 0x30100 和 0x0（寄存器详情请参见芯片手册 9.3.6 小节），使 MIPI RX PHY 处于 CMOS 模式。

## 1.3.2.5 并行 VO 接口设计

Hi3516DV300 的并行 VO（Video output）接口支持 BT.656、BT.1120 和 RGB 输出，不支持 BT.601。

其中 RGB 输出用于对接 LCD 屏，支持 6/8bit 串行 RGB 和 16bit，18bit，24 bit 并行 RGB。详细如表 1-10 所示。

表1-10 信号接口模式与引脚对应关系

信号接口模式	引脚对应关系
BT.1120	Y（亮度）：VOU1120_DATA[15:8] C（色度）：VOU1120_DATA[7:0] CLOCK：VOU1120_CLK
BT.656	DATA：VOU656_DATA[7:0] CLOCK：VOU656_CLK
6 bit Serial RGB	DATA：LCD_DATA[5:0] CLOCK：LCD_CLK HSYNC：LCD_HSYNC VSYNC：LCD_VSYNC DE：LCD_DE
8 bit Serial RGB	LCD_DATA[7:0] CLOCK：LCD_CLK HSYNC：LCD_HSYNC VSYNC：LCD_VSYNC DE：LCD_DE
16 bit Parallel RGB（RGB565）	B[4:0]：LCD_DATA[15:11] G[5:0]：LCD_DATA[10:5] R[4:0]：LCD_DATA[4:0] HSYNC：LCD_HSYNC VSYNC：LCD_VSYNC DE：LCD_DE
18 bit Parallel RGB（RGB666）	B[5:0]：LCD_DATA[17:12] G[5:0]：LCD_DATA[11:6]



信号接口模式	引脚对应关系
	R[5:0]: LCD_DATA [5:0] HSYNC: LCD_HSYNC VSYNC: LCD_VSYNC DE: LCD_DE
24 bit Parallel RGB (RGB888)	R[7:0]: LCD_DATA [23:16] G[7:0]: LCD_DATA [15:8] B[7:0]: LCD_DATA [7:0] HSYNC: LCD_HSYNC VSYNC: LCD_VSYNC DE: LCD_DE

LCD 信号复用在 MIPI TX/RMII/GPIO/JTAG, 16 bit Parallel RGB (RGB565) LCD 来源 MIPI TX 和 RMII, 24 bit Parallel RGB (RGB888) 来源 MIPI TX/RMII/GPIO/JTAG\_TDI。具体见《Hi3516DV300 VO 输出场景详细说明》。

### 注意

当使用非 MIPI TX 功能时, 需要先配置 PHY\_RSTZ 和 PHY\_TST\_CTRL0 寄存器分别为 0x0 和 0x1 (寄存器详情请参见芯片手册 9.4.6 小节), 使 MIPI TX PHY 处于关闭模式。

表1-11 并行 VO 信号设计要求

信号	设计方法
VOU1120_CLK	<b>148MHz 单沿:</b> 在 Hi3516DV300 端串联 33Ω 电阻, 走线长度控制在 2inch 以内。 <b>37MHz 单沿:</b> 在 Hi3516DV300 端串联 33Ω 电阻, 走线长度控制在 10inch 以内。
VOU1120_DATA	<b>74MHz 单沿:</b> 直连, 走线长度控制在 2inch 以内。 <b>18.5MHz 单沿:</b> 直连, 走线长度控制在 10inch 以内。
LCD_CLK	<b>74MHz 单沿:</b> 在 Hi3516DV300 端串联 33Ω 电阻, 走线长度控制在 5inch 以内。 <b>37MHz 单沿:</b> 在 Hi3516DV300 端串联 33Ω 电阻, 走线长度控制在 10inch 以内。
LCD_DATA	<b>37MHz 单沿:</b> 直连, 走线长度控制在 5inch 以内。 <b>18.5MHz 单沿:</b> 直连, 走线长度控制在 10inch 以内。



### 1.3.2.6 MIPI TX 接口设计

Hi3516DV300 内置了一个 MIPI TX PHY，用于对接 MIPI 接口的 LCD 屏。

- AVDD3318\_MIPITX 电源管脚需要与芯片数字电源用磁珠隔离并在芯片管脚端放置 2.2uF 滤波电容。
- DSI\_D0P/N、DSI\_D1P/N、DSI\_D2P/N 和 DSI\_D3P/N 四对差分数据参考差分时钟 DSI\_CKP/N 采样。
- 详细的原理图设计请参考 HI3516DV300DMEBPRO 原理图设计文件。

### 1.3.3 SPI 和 I2C 接口

- Hi3516DV300 有 3 组 SPI 接口，SPI0 用于 Sensor 配置，SPI1/2 用于控制外设。
- Hi3516DV300 有 8 组 I2C 接口，建议 I2C0、I2C1 用于 Sensor 配置，它们与 SPI0 接口复用，具体复用关系请查看《Hi3516DV300\_PINOUT\_CN》。
- I2C 信号推荐接外接 1kΩ 上拉电阻。

#### 注意

I2C7\_SCL、I2C7\_SDA 上拉电源必须与 DVDD3318\_SDIO1 电源保持一致。

### 1.3.4 SDIO 设计

Hi3516DV300 有 2 个 SDIO 接口。

其中 SDIO0 支持 SDIO3.0、SDXC 存储卡；

SDIO1 只支持对接 WIFI，接口支持 1.8V 和 3.3V 电平；

SDIO0\_CARD\_DETECT 和 SDIO0\_CARD\_POWER\_EN 只支持 3.3V。

SDIO 信号设计要求如表 1-12 所示。

表1-12 SDIO 信号设计要求

信号	设计方法
SDIO0_VOUT	在 SOC 端接 1 个 470nF 的电容到地。
SDIO0_CCLK_OUT	在 SOC 端串联 33Ω 电阻，走线长度不能超过 4inch。
SDIO0_CDATA[0:3] SDIO0_CMD	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在 SOC 端串联 33Ω 电阻，走线长度不能超过 4inch，预留 47K 上拉电阻。</li><li>• 走线长度不超过 2inch 时，SOC 端可不匹配电阻。</li></ul>
SDIO0_CARD_DETECT	在对接 SD 卡时，SDIO0_CARD_DETECT 信号必须外接上拉电阻到 3.3V，阻值推荐 10kΩ。



信号	设计方法
SDIO1_CCLK_OUT	在 SOC 端串联 33Ω 电阻，走线长度不能超过 4inch。
SDIO1_CDATA[0:3] SDIO1_CMD	走线长度不能超过 4inch，SOC 端可不串匹配电阻，预留 47K 上拉电阻。

### 1.3.5 USB2.0 接口

Hi3516DV300 提供 1 个 USB2.0 接口，支持 Host 或者 Device，不支持 OTG。

- AVDD33\_USB 与系统 3.3V 电源合并，靠近管脚放置一个 2.2μF 电容。
- USB\_VBUS 在 device 模式时通过 2 个 10K 电阻分压 5V0\_USBS 做输入检测；仅用 host 模式时，该管脚可悬空；若在 host 模式下支持裸烧功能，该管脚需要上拉 3.3V 电源。
- USB2.0 信号上要有 ESD 保护措施，ESD 器件的寄生电容要求小于 1pF，ESD 器件靠近 USB 接口放置。

### 1.3.6 ADC

Hi3516DV300 支持 2 路模拟信号输入，进行 AD 转换。这 2 个管脚均可复用为 GPIO 信号。

### 1.3.7 RTC

内置 RTC 在固定分频模式，计时精度主要取决于外置晶体，请综合考虑晶体频率误差、温度漂移等因素，选择合适的晶体；对计时精度要求较严格的产品，建议选择外置高精度集成 RTC。

#### 注意

- RTC\_XIN 为 RTC 时钟输入管脚。
- DVDD3318\_PC 掉电后，AVDD\_BAT 必须保持供电，否则时间会被复位。

### 1.3.8 PWM

Hi3516DV300 有个 3 PWM。SOC 的 SVB\_PWM 只能用做 Core 电源调压，PWM[0:1] 用于对接外设。

所有 PWM 接口不使用时均可复用为 GPIO 使用。

### 1.3.9 UART

Hi3516DV300 支持 5 个 UART 接口，除了 UART0/4 是 2 线串口，其余 UART 均是 4 线串口。



UART0 用于系统调试。

## 1.4 特殊管脚说明

### 1.4.1 未使用的模块处理

未使用的模块电源和管脚处理建议如表 1-13 所示。

表1-13 未使用模块电源及管脚处理建议

Net Name	POWER	STATUS(IF NOT USED)	NOTES
AVDD33_AC	-	TIED TO 3.3V	-
AVSS_AC	-	TIED TO VSS	-
AC_INL	AVDD33_AC	N.C.	-
AC_INR			-
AC_MICBIAS			-
AC_OUTL			-
AC_OUTR			-
AC_VREF			-
AVDD3318_MIPITX		TIED TO 1.8V/ 3.3V	-
DSI_CKN	AVDD3318_MIPITX	N.C.	-
DSI_CKP			-
DSI_D0N			-
DSI_D0P			-
DSI_D1N			-
DSI_D1P			-
DSI_D2N			-
DSI_D2P			-
DSI_D3N			-
DSI_D3P			-
GPIO0_0	DVDD33	N.C.	-
GPIO0_1			-





Net Name	POWER	STATUS(IF NOT USED)	NOTES
GPIO0_2			–
GPIO0_3			–
GPIO0_4			–
GPIO0_5			–
GPIO0_6			–
I2C2_SCL	DVDD33	N.C.	–
I2C2_SDA			–
I2C7_SCL	DVDD3318_SDIO1	N.C.	–
I2C7_SDA			–
JTAG_TCK	DVDD33	N.C.	
JTAG_TDI			
JTAG_TDO			–
JTAG_TMS			–
JTAG_TRSTN			–
AVDD3318_LSADC		TIED TO 1.8V/ 3.3V	
LSADC_CH0	AVDD3318_LSADC	N.C.	–
LSADC_CH1			–
AVDD3318_MIPIRX	-	TIED TO 1.8V/ 3.3V	
AVSS_MIPIRX	-	TIED TO VSS	
VI_DATA8	AVDD3318_MIPIRX	N.C.	–
VI_DATA9			–
MIPI_RX_CK0N			–
MIPI_RX_CK0P			–
MIPI_RX_D0N			–
MIPI_RX_D0P			–
MIPI_RX_D1N			–
MIPI_RX_D1P			–
MIPI_RX_D2N			–



Net Name	POWER	STATUS(IF NOT USED)	NOTES
MIPI_RX_D2P			-
MIPI_RX_D3N			-
MIPI_RX_D3P			-
SVB_PWM	DVDD33	N.C.	-
PWM0			-
PWM1			-
AVDD_BAT	-	N.C.	-
AVSS_RTC	-	TIED TO VSS	
RTC_XIN	-	N.C.	
RTC_XOUT	-	N.C.	
DVDD3318_PC	-	TIED TO 1.8V/ 3.3V	
PWR_BUTTON	DVDD3318_PC	N.C.	
PWR_RSTN			
PWR_SEQ0			
PWR_SEQ1			
PWR_EN			
PWR_STARTUP			
PWR_WAKEUP			
RMII_CLK	DVDD33	N.C.	
RMII_RX_DV			-
RMII_RXD0			-
RMII_RXD1			-
RMII_TX_EN			-
RMII_TXD0			-
RMII_TXD1			-
MDCK			-
MDIO			-
DVDD18_SDIO0	-	TIED TO 1.8V	-



Net Name	POWER	STATUS(IF NOT USED)	NOTES
SDIO0_CARD_DETE CT	DVDD33	N.C.	-
SDIO0_CARD_POWER_EN			-
SDIO0_CCLK_OUT	DVDD33/DVDD18(通过 powerswitch 切换)	N.C.	-
SDIO0_CCMD			-
SDIO0_CDATA0			-
SDIO0_CDATA1			-
SDIO0_CDATA2			-
SDIO0_CDATA3			-
SDIO0_VOUT			-
DVDD3318_SDIO1	-	TIED TO 1.8V/ 3.3V	-
SDIO1_CCLK_OUT	DVDD3318_SDIO1	N.C.	-
SDIO1_CCMD			-
SDIO1_CDATA0			-
SDIO1_CDATA1			-
SDIO1_CDATA2			-
SDIO1_CDATA3			-
DVDD3318_SENSOR	-	TIED TO 1.8V/ 3.3V	-
SENSOR0_CLK	DVDD3318_SENSOR	N.C.	-
SENSOR0_RSTN			-
SPI0_CSN			-
SPI0_SCLK			-
SPI0_SDI			-
SPI0_SDO			-
UART0_RXD	DVDD33	N.C.	-
UART0_TXD			-
DVDD3318_UART1	-	TIED TO 1.8V/ 3.3V	-
UART1_CTSN	DVDD3318_UART1	N.C.	-



Net Name	POWER	STATUS(IF NOT USED)	NOTES
UART1_RTSN			–
UART1_RXD			–
UART1_TXD			–
AVDD33_USB	-	TIED TO 3.3V	–
AVSS_USB	-	TIED TO VSS	–
USB_DM	AVDD33_USB	N.C.	–
USB_DP			–
USB_OVRCUR	DVDD33	N.C.	–
USB_PWREN			–
USB_VBUS			–
DVDD3318_VI	-	TIED TO 1.8V/ 3.3V	–
VI_CLK	DVDD3318_VI	N.C.	–
VI_DATA0			–
VI_DATA1			–
VI_DATA2			–
VI_DATA3			–
VI_DATA4			–
VI_DATA5			–
VI_DATA6			–
VI_DATA7			–
VI_HS			–
VI_VS			–
AVDD09_HDMITX	–	TIED TO 0.9V	–
AVDD33_HDMITX	–	TIED TO 3.3V	–
HDMI_TX0N	AVDD33_HDMITX	N.C.	–
HDMI_TX0P			–
HDMI_TX1N			–
HDMI_TX1P			–



Net Name	POWER	STATUS(IF NOT USED)	NOTES
HDMI_TX2N			-
HDMI_TX2P			-
HDMI_TXCN			-
HDMI_TXCP			-
HDMI_SCL	DVDD33	N.C.	-
HDMI_SDA			-
HDMI_CEC			-
HDMI_HOTPLUG			-

备注：N.C.：浮空

## 1.4.2 5V tolerance 管脚

表1-14 5V tolerance 管脚

管脚名	描述
I2C2_SCL	5V tolerance
I2C2_SDA	
HDMI_SCL	
HDMI_SDA	
HDMI_CEC	
HDMI_HOTPLUG	
USB_VBUS	

## 1.4.3 防倒灌 GPIO 管脚说明

Hi3516DV300 芯片除表 1-15 所示 GPIO 管脚不防倒灌外，其余所有 GPIO 都具有防倒灌功能。

表1-15 不具有防倒灌功能管脚列表

管脚号	管脚名	电源
W2	SDIO0_CCLK_OUT/GPIO1_2	DVDD18_SDIO0/DVDD33
T3	EMMC_RST_N/GPIO0_5	DVDD3318_FLASH



管脚号	管脚名	电源
V1	EMMC_DATA2/GPIO0_7	DVDD3318_FLASH

## 1.5 在 DVDD33 上电过程中出现毛刺的 IO 说明

Hi3516DV300 在 DVDD33 上电过程中 GPIO 口概率性出现毛刺，幅度为 100mV~900mV。IO 毛刺出现在 DVDD33 上升到 400mV~950mV 的阶段，毛刺宽度为 100us~150us。

如场景应用上选用对接 IO 口做开关控制或者使能控制等，请注意 IO 口毛刺是否会影响对接电路功能。对于低速电平信号，在不影响电路功能和性能的情况下，建议 GPIO 上增加合适的对地电容（容值 47nF-100nF）滤除可能出现的毛刺。

表1-16 Hi3516DV300 在 DVDD33 上电过程中出现毛刺的 IO 统计表

管脚号	管脚名	复用功能
C14	GPIO0_0	UPDATE_MODE
A14	GPIO0_1	I2C3_SDA/LCD_DATA20
B14	GPIO0_2	I2C3_SCL/LCD_DATA19
C13	GPIO0_3	IR_IN/LCD_DATA18
B13	GPIO0_4	LCD_DATA21
A13	GPIO0_5	LCD_DATA22
F21	GPIO0_6	LCD_CLK/VOU_CLK
V1	GPIO0_7	EMMC_DATA2/SFC_CSN
AA2	GPIO1_0	SDIO0_CARD_POWER_EN/JTAG_TCK
U4	GPIO1_1	SDIO0_CARD_DETECT
W2	GPIO1_2	SDIO0_CCLK_OUT/JTAG_TRSTN
Y1	GPIO1_3	SDIO0_CCMD
W1	GPIO1_4	SDIO0_CDATA0
V2	GPIO1_5	SDIO0_CDATA1/JTAG_TMS
W3	GPIO1_6	SDIO0_CDATA2/JTAG_TDO
Y2	GPIO1_7	SDIO0_CDATA3/JTAG_TDI
A15	GPIO10_0	DSI_D0P/LCD_DATA8/VOU_DATA15/LCD_DE
B15	GPIO10_1	DSI_D0N/LCD_DATA9/VOU_DATA14/LCD_VSYNC
P21	GPIO10_2	SVB_PWM



管脚号	管脚名	复用功能
P19	GPIO10_3	LSADC_CH0
P18	GPIO10_4	LSADC_CH1
T3	GPIO10_5	EMMC_RST_N/SYS_RSTN_OUT
H18	GPIO10_6	I2C7_SCL
G19	GPIO10_7	I2C7_SDA/RMII_CLK
K18	GPIO11_0	PWR_WAKEUP
H19	GPIO11_1	PWR_SEQ0
J18	GPIO11_2	PWR_SEQ1
K19	GPIO11_3	PWR_EN
AA3	GPIO2_0	USB_OVRCUR
Y3	GPIO2_2	USB_PWREN
Y16	GPIO2_3	VI_CLK/VOU_CLK
W10	GPIO2_4	HDMI_HOTPLUG/UART3_RXD
V10	GPIO2_5	HDMI_CEC/UART3_TXD
Y10	GPIO2_6	HDMI_SDA/UART3_RTSN/I2C4_SDA/FLASH_TRIG
AA10	GPIO2_7	HDMI_SCL/UART3_CTSN/I2C4_SCL/SHUTTER_TRIG
Y19	GPIO3_0	VI_DATA0/VOU_DATA0/I2C5_SCL
AA19	GPIO3_1	VI_DATA1/VOU_DATA1/I2C5_SDA
Y18	GPIO3_2	VI_DATA2/VOU_DATA2/I2C6_SCL
AA18	GPIO3_3	VI_DATA3/VOU_DATA3/I2C6_SDA
W18	GPIO3_4	VI_DATA4/VOU_DATA4/UART2_RTSN/SPI2_SCLK
AA17	GPIO3_5	VI_DATA5/VOU_DATA5/UART2_CTSN/SPI2_SDO
Y17	GPIO3_6	VI_DATA6/VOU_DATA6/UART2_RXD/SPI2_SDI
AA16	GPIO3_7	VI_DATA7/VOU_DATA7/UART2_TXD/SPI2_CSN
V17	GPIO4_0	SENSOR0_CLK
V16	GPIO4_1	SENSOR0_RSTN/BOOT_SEL1
W16	GPIO4_2	SPI0_SCLK/I2C0_SCL/SPI_3LINE_SCLK
Y15	GPIO4_3	SPI0_SDO/I2C0_SDA/SPI_3LINE_SDATA
W15	GPIO4_4	SPI0_SDI/I2C1_SDA/SENSOR_VS
V15	GPIO4_5	SPI0_CSN/I2C1_SCL/SPI_3LINE_CSN/SENSOR_HS
AA20	GPIO4_6	VI_VS/FLASH_TRIG/SENSOR_VS



管脚号	管脚名	复用功能
V18	GPIO4_7	VI_HS/SHUTTER_TRIG/SENSOR_HS
U18	GPIO5_0	UART1_RTSN/UART4_RXD
U19	GPIO5_1	UART1_CTSN/UART4_TXD
T21	GPIO5_2	UART1_RXD
T19	GPIO5_3	UART1_TXD
U21	GPIO5_4	UART0_RXD
T20	GPIO5_5	UART0_TXD
T18	GPIO5_6	I2C2_SDA
R19	GPIO5_7	I2C2_SCL
H20	GPIO6_0	SDIO1_CCLK_OUT/RMII_RX_DV
J21	GPIO6_1	SDIO1_CCMD/EPHY_CLK
G20	GPIO6_2	SDIO1_CDATA0/MDCK
H21	GPIO6_3	SDIO1_CDATA1/MDIO
G21	GPIO6_4	SDIO1_CDATA2/RMII_TX_EN
J20	GPIO6_5	SDIO1_CDATA3/EPHY_RSTN
R21	GPIO6_6	PWM0
R20	GPIO6_7	PWM1
D20	GPIO7_0	RMII_TX_EN/LCD_DATA2/VOU_DATA5
D19	GPIO7_1	RMII_TXD0/LCD_DATA0/VOU_DATA7
B21	GPIO7_2	RMII_CLK/LCD_HSYNC
A20	GPIO7_3	RMII_RX_DV/LCD_DATA6/VOU_DATA1
C20	GPIO7_4	RMII_RXD1/LCD_VSYNC
B20	GPIO7_5	RMII_RXD0/LCD_DE
D21	GPIO7_6	EPHY_RSTN/LCD_DATA3/VOU_DATA4/SFC_DEVICE_MODE
F20	GPIO7_7	EPHY_CLK/LCD_DATA7/VOU_DATA0
F19	GPIO8_0	JTAG_TRSTN/SPI1_SCLK/RMII_TXD1/I2S_MCLK
E19	GPIO8_1	JTAG_TCK/SPI1_SDO/RMII_RXD1/I2S_BCLK_TX
G18	GPIO8_2	JTAG_TMS/SPI1_CSN0/RMII_TXD0/I2S_WS_TX
F18	GPIO8_3	JTAG_TDO/SPI1_SDI/RMII_RXD0/I2S_SD_TX
E18	GPIO8_4	JTAG_TDI/SPI1_CSN1/LCD_DATA23/I2S_SD_RX





管脚号	管脚名	复用功能
E21	GPIO8_5	MDIO/LCD_DATA5/VOU_DATA2
E20	GPIO8_6	MDCK/LCD_DATA4/VOU_DATA3/BOOT_SEL0
C21	GPIO8_7	RMII_TXD1/TEST_CLK/LCD_DATA1/VOU_DATA6
A19	GPIO9_0	DSI_D3P/LCD_DATA16/SHUTTER_TRIG/LCD_DATA5
B19	GPIO9_1	DSI_D3N/LCD_DATA17/FLASH_TRIG/LCD_CLK
B18	GPIO9_2	DSI_D2N/LCD_DATA14/VOU_DATA9/LCD_DATA3
C18	GPIO9_3	DSI_D2P/LCD_DATA15/VOU_DATA8/LCD_DATA4
A17	GPIO9_4	DSI_CKP/LCD_DATA12/VOU_DATA11/LCD_DATA1
B17	GPIO9_5	DSI_CKN/LCD_DATA13/VOU_DATA10/LCD_DATA2
B16	GPIO9_6	DSI_D1N/LCD_DATA10/VOU_DATA13/LCD_HSYNC
C16	GPIO9_7	DSI_D1P/LCD_DATA11/VOU_DATA12/LCD_DATA0

Cogobuy Only For Shenzhen FuShi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.



# 2 PCB 设计

## 2.1 电源与滤波电容设计

### 注意

主芯片下方的电源包括内核电源、PLL 电源、AVDD3318\_MIPITX 等的滤波电容材质推荐选择 X6 或者 X7。

### 2.1.1 DVDD 电源

DVDD 电源的滤波电容容值、数量和布局要求复制 HI3516DV300DMEB 的设计。

#### 滤波电容类型、数量和布局

去耦电容布局要求如下：

- DVDD 电源域的滤波电容组合为  $4.7\mu\text{F} \times 3 + 220\text{ nF} \times 4 + 100\text{ nF} \times 2$ 。
- 滤波电容的摆放位置**必须参考** HI3516DV300DMEB 的设计

### 2.1.2 DDR IO 电源设计

设计时滤波电容类型、数量和布局要求复制 HI3516DV300DMEB 的设计。

#### 滤波电容类型、数量和布局

去耦电容布局要求如下：

- DDR IO 电源域的滤波电容组合为  $4.7\mu\text{F} \times 3 + 220\text{ nF} \times 3$ 。
- 滤波电容的摆放位置**必须参考** HI3516DV300DMEB 的设计

VDDIO\_DDR\_CK 需要使用磁珠与 1.5V/1.35V 电源隔离，靠近芯片管脚处放置 1 个  $2.2\mu\text{F}$  的电容。

## 2.1.3 PLL 电源设计

- AVDD09\_PLL 与 DVDD 内核电源之间用磁珠（ $1k\Omega @100M$ ）进行隔离。如图 2-1 和图 2-2 所示。

图2-1 AVDD09\_PLL 供电滤波电路 SCH 设计

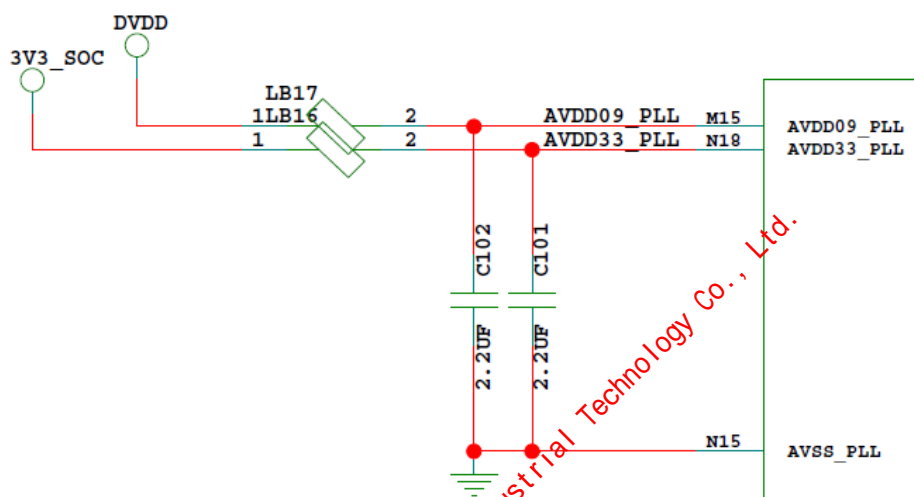
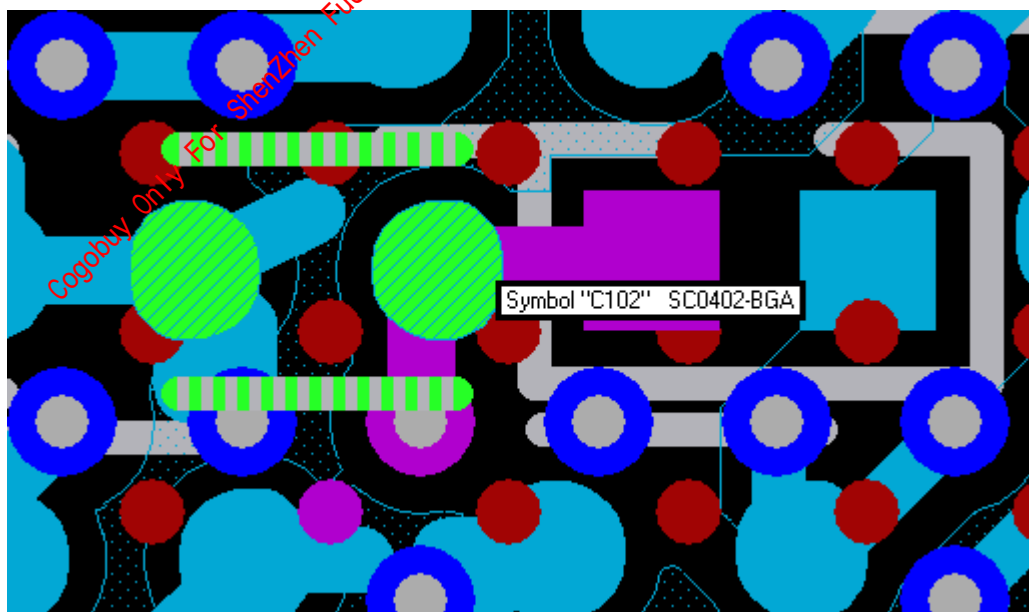


图2-2 AVDD09\_PLL 供电滤波电路 PCB 设计



- AVDD33\_PLL 与数字 3.3V 电源之间用磁珠（ $1k\Omega @100M$ ）进行隔离。如图 2-3 和图 2-4 所示。

图2-3 AVDD33\_PLL 供电滤波电路 SCH 设计

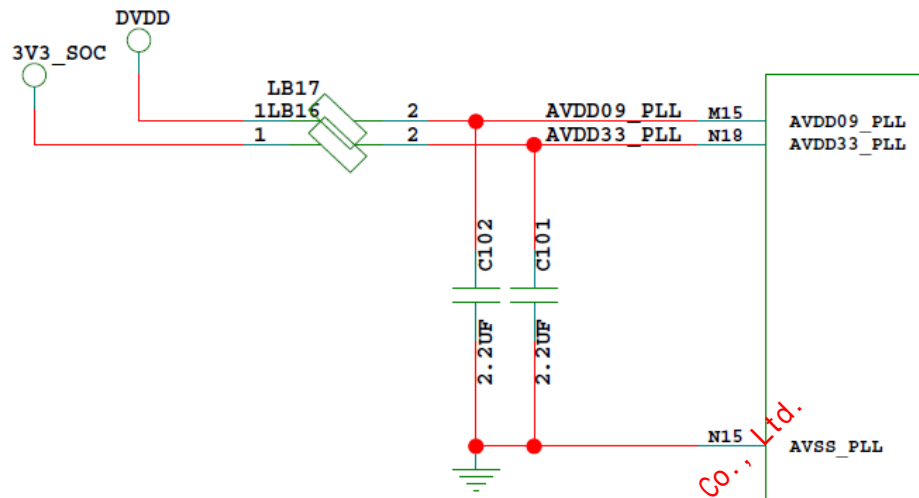
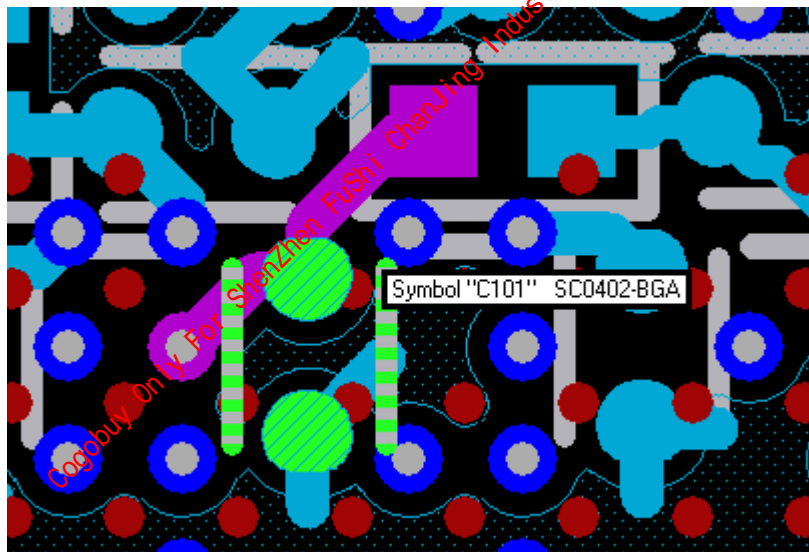


图2-4 AVDD33\_PLL 供电滤波电路 PCB 设计



- AVDD33\_DDR\_PLL 与数字 3.3V 电源之间用磁珠（ $1k\Omega @ 100M$ ）进行隔离。如图 2-5 和图 2-6 所示。

图2-5 AVDD33\_DDR\_PLL 供电滤波电路 SCH 设计

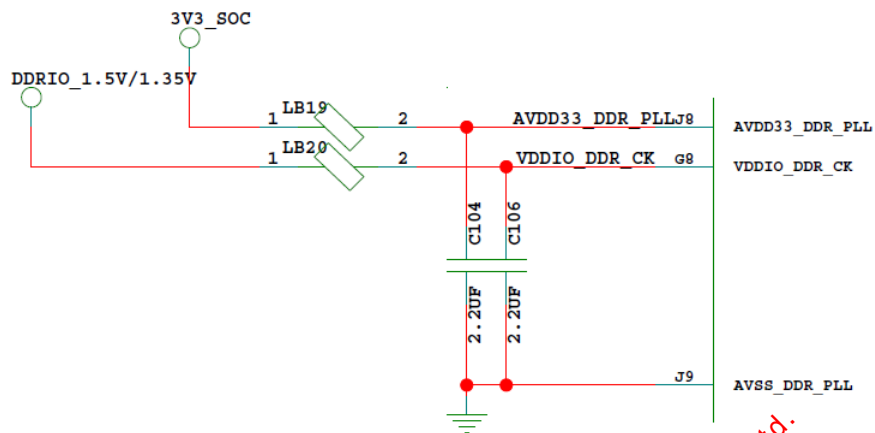
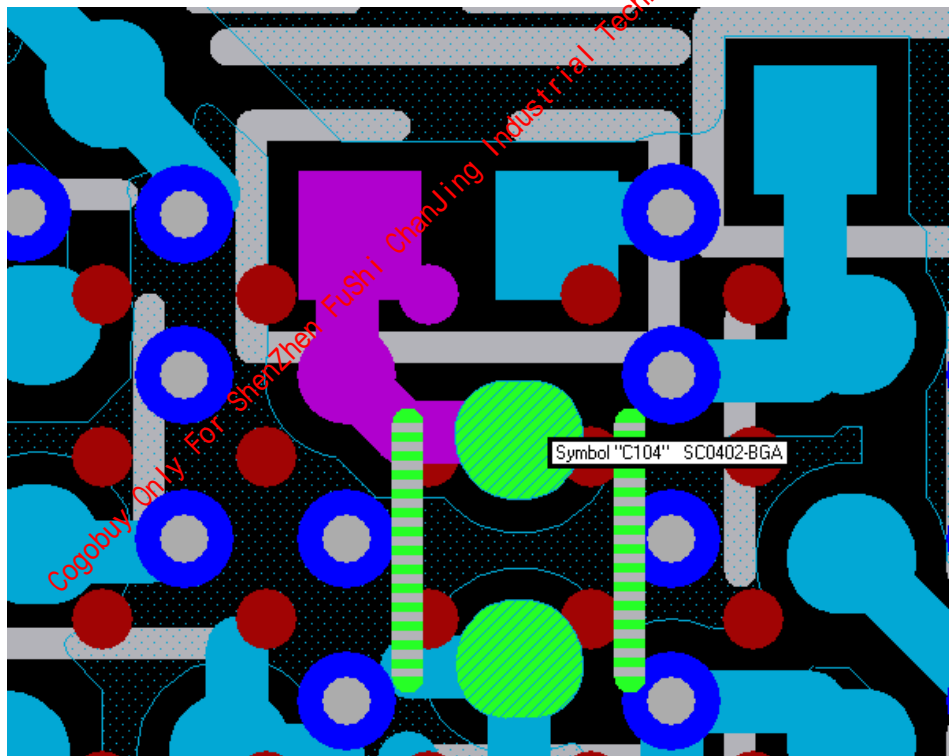


图2-6 AVDD33\_DDR\_PLL 供电滤波电路 PCB 设计



## 2.1.4 模拟音频电源设计

AVDD33\_AC 与数字 3.3V 电源之间用磁珠进行隔离，并在靠近芯片管脚的位置至少放置一个 2.2uF 电容。



## 2.2 晶体电路设计

晶体的 Xin、Xout、RTC\_XIN、RTC\_XOUT 信号走线全程做包地处理，并保证这些信号有完整的参考平面。晶体电路下方不能有高速信号穿过。

## 2.3 DDR 电路设计

Hi3516DV300 对接双颗粒 16bit DDR3(L) flyby 拓扑时，PCB layout 必须完全拷贝 HI3516DV300DMEB 设计；

Hi3516DV300 对接双颗粒 16bit DDR3(L) T 型拓扑时，PCB layout 必须完全拷贝 HI3516DV300DMEBPRO 设计；

Hi3516DV300 对接双颗粒 16bit DDR4 flyby 拓扑时，PCB layout 必须完全拷贝 HI3516DV300DDR4DMEB 对应部分设计。

Hi3516DV300 对接双颗粒 16bit DDR4 T 型拓扑时，PCB layout 必须完全拷贝 HI3516DV300DMEBLITE 对应部分设计。

## 2.4 FLASH 电路设计

### 2.4.1 SPI FLASH

SPI FLASH 信号设计要求如下。

- 避免信号走线穿越电源分割区域，并保持信号参考平面完整。
- 相邻信号走线间距保持“3W”原则。
- SFC\_CSN、SFC\_MOSI\_IO0、SFC\_MISO\_IO1、SFC\_WP\_IO2、SFC\_HOLD\_IO3 的线长以 SFC\_CLK 的线长为基准，误差控制在 $\pm 1000\text{mil}$  以内。
- 上述等长约束为封装加 PCB 联合控制等长。

### 2.4.2 eMMC

eMMC 信号设计要求如下，

- 避免信号走线穿越电源分割区域，并保持信号参考平面完整；
- 相邻信号走线间距保持“3W”原则；
- EMMC\_DATA[0:3]、EMMC\_CMD 的线长以 EMMC\_CLK 的线长为基准，误差控制在 $\pm 300\text{mil}$  以内。
- 上述等长约束为封装加 PCB 联合控制等长。

## 2.5 RMII 信号 PCB 设计

RMII 信号设计要求如下。



- 避免信号走线穿越电源分割区域，并保持信号参考平面完整；
- 相邻信号走线间距保持“3W”原则；
- RMII\_TXD[0:1]、RMII\_TX\_EN 的线长以 RMII\_CLK 的线长为基准，误差控制在  $\pm 500\text{mil}$  以内；  
RMII\_RXD[0:1]、RMII\_RX\_DV 的线长以 RMII\_CLK 的线长为基准，误差控制在  $\pm 500\text{mil}$  以内；
- MDI0+、MDI0-、MDI1+、MDI1 差分线对长度控制在  $\pm 5\text{mil}$ ，差分阻抗控制在  $100\Omega$ 。
- 上述等长约束为封装加 PCB 联合控制等长。

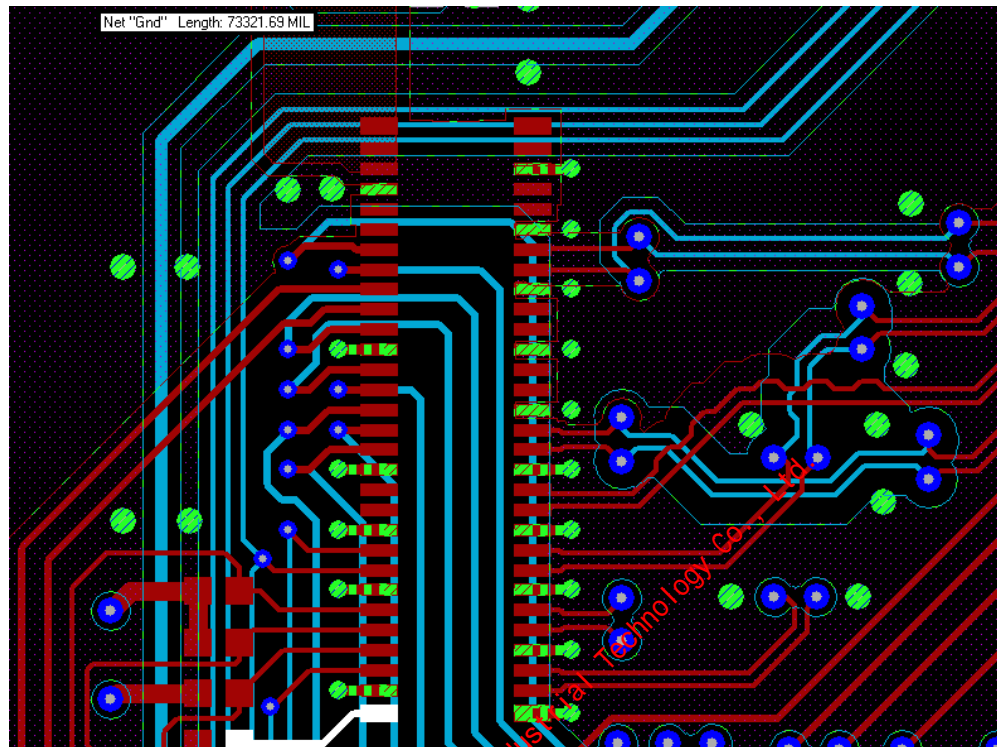
## 2.6 Video Input 信号 PCB 设计

### 2.6.1 MIPI RX

MIPI RX 信号设计要求如下：

- 差分信号以 GND 为参考平面，并保持参考平面完整；
- PCB 走线建议 4inch 以内，差分对 P/N 等长控制在 5mil 以内，对间以采样差分时钟为参考，等长控制在正负 300mil 以内；
- MIPIRX 差分对的 PCB 走线控制差分阻抗  $100\text{ohm} \pm 10\%$ ；
- 差分信号经过连接器时，相邻差分信号对之间必须使用 GND 管脚进行隔离，如图 2-7 所示。黄色是 GND 网络，红色是差分线对。
- 上述等长约束为封装加 PCB 联合控制等长。

图2-7 MIPI/LVDS 差分信号隔离示意图



## 2.6.2 Parallel CMOS

Parallel CMOS 信号设计要求如下：

- 避免信号走线穿越电源分割区域，并保持信号参考平面完整；
- 相邻信号走线间距保持“3W”原则；
- VI\_DATA[0:15]、VI\_HS 和 VI\_VS 的线长以 VI\_CLK 的线长为基准，偏差控制在  $\pm 500\text{mil}$ 。
- 上述等长约束为封装加 PCB 联合控制等长。

## 2.7 Video Output 信号 PCB 设计

Video Output 信号设计要求如下：

- 避免信号走线穿越电源分割区域，并保持信号参考平面完整；
- 相邻信号走线间距保持“3W”原则；
- VOU\_DATA[0:15]的线长以 VOU\_CLK 的线长为基准，偏差控制在  $\pm 500\text{mil}$ ；
- 上述等长约束为封装加 PCB 联合控制等长。

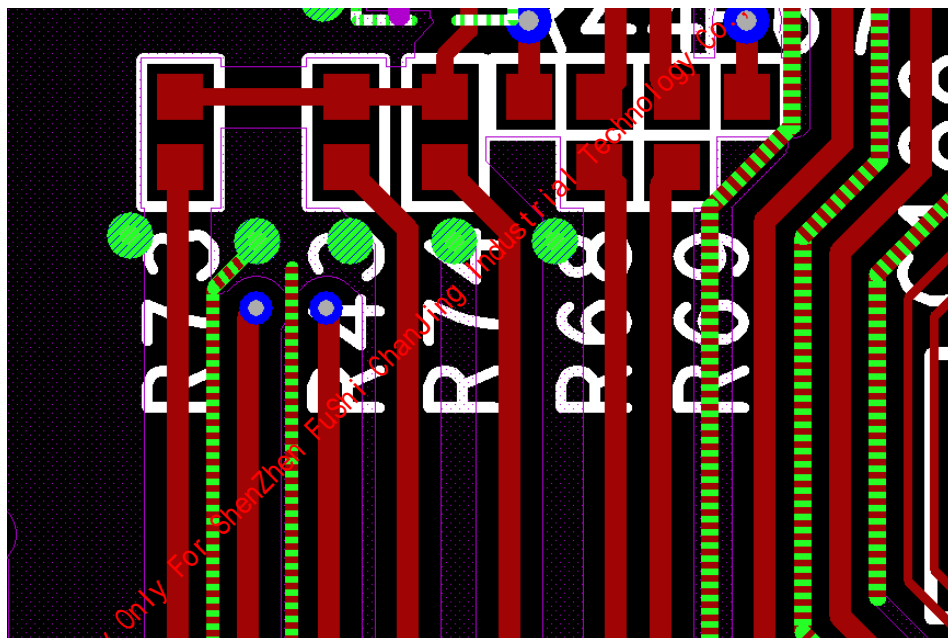


## 2.8 模拟音频电路设计

模拟音频电路走线设计要求如下：

- AC\_VREF 管脚上对接的电容需要靠近主芯片放置，最大间距不超过 150mil。
- 在使用 MIC 输入时，为获得较好的音频质量，建议 AC\_MICBIAS 信号在 Hi3516DV300 端将信号分为两路，各自对应做左声道及右声道的偏置电平，详细请参考 HI3516DV300DMEB 板最新版本原理图。
- 模拟音频输入输出信号、MICBIAS 信号以 GND 为参考平面，并保证参考平面完整。
- 模拟音频输入输出信号、MICBIAS 信号要求全程包地处理，并且相邻信号之间的 GND 过孔均匀放置，如图 2-8 所示。

图2-8 模拟音频信号包地示意图



## 2.9 SDIO 信号 PCB 设计

SDIO 信号设计要求如下：

- 相邻信号走线间距保证“3W”原则。
- SDIO0/1\_CDATA[0:3]、SDIO0/1\_CCMD 的线长以 SDIO0/1\_CCLK\_OUT 的线长为基准，偏差控制在 $\pm 500\text{mil}$ 。
- 如果 SDIO0 需要支持 SDXC 卡，那么 SDIO0 的数据信号必须以 GND 为参考平面，并保持信号参考平面完整。
- 上述等长约束为封装加 PCB 联合控制等长。



## 2.10 USB2.0 信号设计

USB2.0 信号设计要求如下：

- 差分信号组内走线长度偏差控制在 $\pm 5\text{mil}$ 以内，差分阻抗控制在 $90\Omega \pm 10\%$ 。
- 差分信号必须以 GND 为参考平面，并保持信号参考平面完整。
- Hi3516DV300 的 USB2.0 接口外接插座时，差分信号线走线长度不大于 5inch，过孔数量不超过 2 个，外挂线缆长度控制在 1.5 米以内；当 USB2.0 信号做板级级联时，差分信号线走线长度不大于 10inch，过孔数量不超过 2 个。

USB2.0 信号过孔附近需要放置一个 GND 过孔，以获取更好的信号质量。

- 避免邻近其他信号，并保证与其他信号的间距大于 20mil。
- ESD 器件寄生电容建议小于 1pF。
- 上述等长约束为封装加 PCB 联合控制等长。

## 2.11 MIPI TX 信号设计

MIPI TX 信号设计要求如下：

- MIPITX 差分对的 PCB 走线控制差分阻抗  $100\text{ohm} \pm 10\%$
- 差分信号必须以 GND 为参考平面，并保持信号参考平面完整。
- 如果使用 FPC 连接，建议 PCB+FPC 的总长不超过 9inch。
- 差分对 P/N 等长控制在 5mil 以内，对间需要与 CLK 做等长处理 100mil。
- 避免邻近其他信号，并保证与其他信号的间距大于 20mil。
- 上述等长约束为封装加 PCB 联合控制等长。

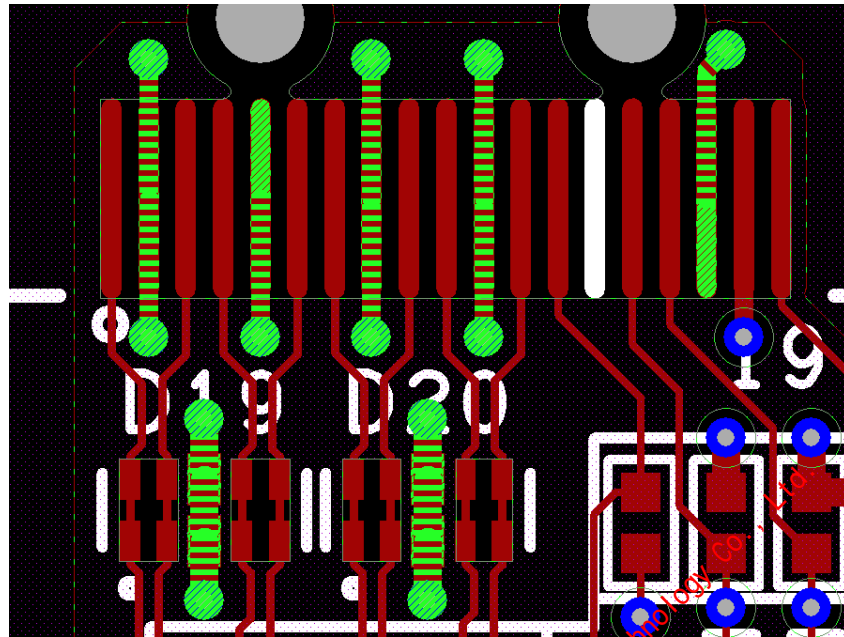
## 2.12 HDMI TX 信号设计

HDMI TX 信号设计要求如下：

- HDMI TX 差分对的 PCB 走线控制差分阻抗  $100\text{ohm} \pm 10\%$
- 差分信号必须以 GND 为参考平面，并保持信号参考平面完整。
- 板级走线长度应尽量短，建议 5in 以内，尽量缩短 fanout 区域内的走线长度，强烈建议表层走线。
- 差分对 P/N 等长控制在 5mil 以内。
- 差分走线应保证阻抗连续，差分对间等长在 50mil 以内，以阻抗连续优先(尽量不走蛇形线)。
- 接插件和 ESD 器件应选择寄生电容尽量小的，两者总的寄生电容值不超过 2pF。
- 由于 ESD 器件以及连接器存在寄生电容，导致阻抗偏低，需对该处进行阻抗补偿。将 ESD 器件以及连接器件下方的 VSS 平面挖空，并且在 ESD 挖空旁边增加 VSS 过孔；参考设计如图 2-9 所示。
- 上述等长约束为封装加 PCB 联合控制等长。



图2-9 模拟音频信号包地示意图





# 3 整机 ESD 设计

## 3.1 背景

由于芯片性能提高，时钟频率越来越高，整机对外界干扰更敏感，客户在整机设计时需要非常重视整机的 ESD 设计。

Hi3516DV300 芯片本身的 ESD 测试是按照 JEDEC 标准，通过 $\pm 2000\text{V}$ 测试，符合行业标准。而客户需要根据自己企业的 ESD 测试标准，对单板硬件设计和整机设计做评估。本文针对整机 ESD 设计风险，提供一些设计建议和风险规避措施。

## 3.2 整机 ESD 设计

- 关于系统 24MHz 时钟设计，要求客户选用 4pin 贴片晶振，其中 2 个 GND 管脚与单板地充分连接，增强系统时钟抗干扰能力。其他的走线远离晶振区域，不要在晶振底下有走线通过。
- 建议 PCB 器件布局设计时，小系统部分离金属接口部分越远，整机 ESD 性能越好。
- 单板对外的接插件（例如音视频输入输出接口、USB、网口等端口），需要增加 ESD 保护器件，加强接口的抗干扰能力。
- 整机设计为浮地设备时，单板金属化接口部分严禁采用分割地设计。
- 单板定位孔采用金属化过孔，并与单板 GND 连接，确保单板 GND 通过螺丝孔与金属外壳充分连接。
- 整机为接地设备时，要求金属外壳充分连接大地，分割保护地与单板数字地之间采用单点连接，单点连接的位置要远离小系统电路，建议靠近整机电源连接器放置。
- 接口连接器外壳推荐采用金属外壳，且与整机金属外壳充分连接（例如带定位螺丝的 HDMI 口和 USB 口，带弹片的 RJ45 口等），必要时甚至采用导电柱或者导电泡棉来实现连接器与外壳的充分连接。

以上措施请根据自身企业标准和工程经验综合评估。



# 4 芯片散热设计

## 4.1 最大功耗

Hi3516DV300 仿真预估最大功耗为 2W，该数据仅供参考，最终的功耗数据以最新发布《Hi3516DV300 功耗测试报告》为准。

Cogobuy Only For ShenZhen FuShi ChanJing Industrial Technology Co., Ltd.